

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 1 1 日
Date of Application:

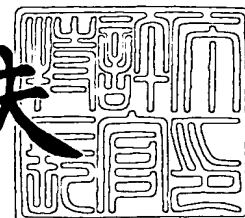
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 6 5 3 2 4
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 6 5 3 2 4]

出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 2 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 1 3 8 3 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0097207

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/12

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 平井 利充

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 長谷井 宏宣

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100095728

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 上柳 雅誉

 【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

 【識別番号】 100107076

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 藤網 英吉

【選任した代理人】

 【識別番号】 100107261

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パターンの形成方法及びパターン形成装置、デバイスの製造方法、導電膜配線、電気光学装置、並びに電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液体材料の液滴を基板上に配置することにより膜パターンを形成するパターンの形成方法であって、

前記基板上に前記膜パターンを形成するパターン形成領域を複数並べて設定し、前記複数のパターン形成領域のうち、前記膜パターンの側部から形成する第 1 パターン形成領域と、前記膜パターンの中央部から形成する第 2 パターン形成領域とを設定し、前記第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれに前記液滴を配置して前記膜パターンを形成することを特徴とするパターンの形成方法。

【請求項 2】 前記第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれに対して前記液滴をほぼ同時に配置する工程を有することを特徴とする請求項 1 記載のパターンの形成方法。

【請求項 3】 前記第 1、第 2 パターン形成領域のうちいずれか一方に前記液滴を配置する工程を有することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のパターンの形成方法。

【請求項 4】 前記第 1 パターン形成領域においては前記側部を形成した後に中央部を形成し、前記第 2 パターン形成領域においては前記中央部を形成した後に側部を形成することを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか一項記載のパターンの形成方法。

【請求項 5】 前記第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれに対応して前記液滴を配置する吐出部を複数設け、前記パターン形成領域の並び方向に前記吐出部を移動しながら前記液滴を配置することを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか一項記載のパターンの形成方法。

【請求項 6】 前記第 1 パターン形成領域に形成する第 1 の膜パターンの一方の側部を形成する工程と、

前記第 1 の膜パターンの他方の側部を形成するとともに前記第 2 パターン形成領域に形成する第 2 の膜パターンの中央部を形成する工程と、

前記第 1 の膜パターンの中央部を形成するとともに前記第 2 の膜パターンの一方及び他方のいずれかの側部を形成する工程とを有することを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか一項記載のパターンの形成方法。

【請求項 7】 液体材料の液滴を基板上に配置することにより膜パターンを形成するパターンの形成方法であって、

前記基板上に複数並べて前記膜パターンを形成する際、前記複数の膜パターンのうち、第 1 の膜パターンの第 1 領域を形成する第 1 工程と、

前記第 1 の膜パターンの第 2 領域を形成するとともに第 2 の膜パターンの第 1 領域を形成する第 2 工程と、

前記第 1 の膜パターンの第 3 領域を形成するとともに前記第 2 の膜パターンの第 2 領域を形成する第 3 工程とを有することを特徴とするパターンの形成方法。

【請求項 8】 前記第 3 工程の後に前記第 2 の膜パターンの第 3 領域を形成する第 4 行程を有することを特徴とする請求項 7 記載のパターン形成方法。

【請求項 9】 前記液体材料は導電性微粒子を含む液状体であることを特徴とする請求項 1 ～ 8 のいずれか一項記載のパターンの形成方法。

【請求項 10】 液体材料の液滴を基板上に配置する液滴吐出装置を備え、前記液滴により膜パターンを形成するパターン形成装置であって、

前記液滴吐出装置は、前記基板上に予め複数並んで設定され前記膜パターンを形成するパターン形成領域のうち、第 1 パターン形成領域に形成する第 1 の膜パターンを側部から形成し、第 2 パターン形成領域に形成する第 2 の膜パターンを中央部から形成することを特徴とするパターン形成装置。

【請求項 11】 液体材料の液滴を基板上に配置する液滴吐出装置を備え、前記液滴により前記基板上に複数の膜パターンを形成するパターン形成装置であって、

前記液滴吐出装置は、第 1 の膜パターンの第 1 領域を形成した後、前記第 1 の膜パターンの第 2 領域を形成するとともに第 2 の膜パターンの第 1 領域を形成し、次いで、前記第 1 の膜パターンの第 3 領域を形成するとともに前記第 2 の膜パターンの第 2 領域を形成することを特徴とするパターン形成装置。

【請求項 12】 配線パターンを有するデバイスの製造方法において、

前記基板上に複数並んで設定され前記配線パターンを形成するパターン形成領域のそれぞれに対して液体材料の液滴を配置することにより前記配線パターンを形成する材料配置工程を有し、

前記材料配置工程は、前記複数のパターン形成領域のうち、前記配線パターンの側部から形成する第1パターン形成領域と、前記配線パターンの中央部から形成する第2パターン形成領域とを設定し、前記第1、第2パターン形成領域のそれぞれに前記液滴を配置して前記配線パターンを形成することを特徴とするデバイスの形成方法。

【請求項13】 配線パターンを有するデバイスの製造方法において、液体材料の液滴を基板上に配置することにより複数の配線パターンを形成する材料配置工程を有し、

前記材料配置工程は、前記複数の配線パターンのうち、第1の配線パターンの第1領域を形成する第1工程と、

前記第1の配線パターンの第2領域を形成するとともに第2の配線パターンの第1領域を形成する第2工程と、

前記第1の配線パターンの第3領域を形成するとともに前記第2の配線パターンの第2領域を形成する第3工程とを有することを特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項14】 請求項10又は11記載のパターン形成装置により形成されたことを特徴とする導電膜配線。

【請求項15】 請求項14記載の導電膜配線を備えることを特徴とする電気光学装置。

【請求項16】 請求項15記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液体材料の液滴を基板上に配置することにより膜パターンを形成するパターンの形成方法及びパターン形成装置、デバイスの製造方法、導電膜配線

、電気光学装置、並びに電子機器に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来より、半導体集積回路など微細な配線パターン（膜パターン）を有するデバイスの製造方法としてフォトリソグラフィ法が多用されているが、液滴吐出法を用いたデバイスの製造方法が注目されている。この液滴吐出法は液体材料の消費に無駄が少なく、基板上に配置する液体材料の量や位置の制御を行いやすいという利点がある。下記特許文献には液滴吐出法に関する技術が開示されている。

【0 0 0 3】

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 2 7 4 6 7 1 号公報

【特許文献 2】

特開 2 0 0 0 - 2 1 6 3 3 0 号公報

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、配線パターンの配線ピッチは製造するデバイスに応じて種々変更される。一方で、液滴吐出法では所定のピッチで並べられた吐出ノズルを有する液滴吐出ヘッドより基板に液滴を吐出する。そのため、配線パターンの配線ピッチを設計値上で種々変更しても 1 つの液滴吐出ヘッドで高スループットに配線パターンを形成する必要がある。

【0 0 0 5】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、複数並んだ吐出ノズルを有する液滴吐出ヘッドのそれぞれから液滴を吐出して膜パターンを形成する際、パターンピッチが設計値上において種々変更されても効率良く膜パターンを形成できるパターンの形成方法及びパターン形成装置、デバイスの製造方法を提供することを目的とする。更に本発明は、配線パターンを高スループットで製造することによりコスト的に有利な導電膜配線、電気光学装置、及びこれを用いた電子機器を提供することを目的とする。

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、本発明のパターン形成方法は、液体材料の液滴を基板上に配置することにより膜パターンを形成するパターンの形成方法であって、前記基板上に前記膜パターンを形成するパターン形成領域を複数並べて設定し、前記複数のパターン形成領域のうち、前記膜パターンの側部から形成する第1パターン形成領域と、前記膜パターンの中央部から形成する第2パターン形成領域とを設定し、前記第1、第2パターン形成領域のそれぞれに前記液滴を配置して前記膜パターンを形成することを特徴とする。

本発明によれば、複数並んだパターン形成領域のそれぞれに液滴を配置して例えば所定の線幅を有する膜パターンを形成する際、第1パターン形成領域では側部から膜パターンを形成し、第2パターン形成領域では中央部から膜パターンを形成するようにしたので、換言すれば基板上での液滴配置順序（膜パターンの各部の形成位置順序）を各パターン形成領域毎に異なるように設定したので、液滴吐出ヘッドの吐出ノズルピッチと製造するパターンピッチとが異なっても、第1、第2パターン形成領域のそれぞれについて膜パターンを効率良く形成することができる。つまり、ノズルピッチとパターンピッチとが互いに異なる場合、全ての膜パターンのそれぞれについて同じ液滴配置順序で液滴を配置しようとすると、複数の吐出ノズルのうち液滴を吐出ししない状態（吐出休止状態、配置休止状態）の吐出ノズルの数が増えてしまい、低スループット化を招くことになる。しかしながら、各パターン形成領域のそれぞれについて液滴配置順序を異なるようにすることで、つまり、第1パターン形成領域については側部から形成し始め、第2パターン形成領域については中央部から形成し始めるようにしたので、ノズルピッチとパターンピッチとが互いに異なっても吐出休止状態の吐出ノズルの数を低減することができ、高スループット化を図ることができる。

【0007】

本発明のパターンの形成方法において、前記第1、第2パターン形成領域のそれぞれに対して前記液滴をほぼ同時に配置する工程を有することを特徴とする。

本発明によれば、ノズルピッチとパターンピッチとが異なっても、吐出ノズルと基板との相対位置を変更することで第1及び第2パターン形成領域の位置

と複数の吐出ノズル位置とが一致する状態が生じる。そこで、前記状態において第 1 及び第 2 パターン形成領域のそれぞれに液滴を同時に配置することで高スループット化を実現できる。

【0008】

本発明のパターン形成の形成方法において、前記第 1、第 2 パターン形成領域のうちいずれか一方に前記液滴を配置する工程を有することを特徴とする。

本発明によれば、ノズルピッチとパターンピッチとが異なっても、吐出ノズルと基板との相対位置を変更することで第 1 及び第 2 パターン形成領域のいずれか一方の位置と吐出ノズル位置とが一致する状態が生じる。そこで、前記状態において吐出ノズルとの位置が一致した第 1 及び第 2 パターン形成領域のいずれか一方に液滴を配置することで、吐出休止状態の吐出ノズルの数を抑えることができ高スループット化を実現できる。

【0009】

本発明のパターンの形成方法において、前記第 1 パターン形成領域においては前記側部を形成した後に中央部を形成し、前記第 2 パターン形成領域においては前記中央部を形成した後に側部を形成することを特徴とする。

本発明によれば、第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれについて液滴配置順序を互いに異なるように設定したので、ノズルピッチとパターンピッチとが互いに異なっても吐出ノズルに対して位置合わせされた第 1、第 2 パターン形成領域に液滴を配置することで、吐出休止状態の吐出ノズルの数を低減することができ、高スループット化を図ることができる。そして、第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれについて中央部及び側部を形成することで幅広の配線パターンを形成することができ、電気伝導に有利な膜パターンを形成できる。

【0010】

本発明のパターンの形成方法において、前記第 1、第 2 パターン形成領域のそれぞれに対応して前記液滴を配置する吐出部を複数設け、前記パターン形成領域の並び方向に前記吐出部を移動しながら前記液滴を配置することを特徴とする。

本発明によれば、複数並んだパターン形成領域のそれぞれに対応するように吐出部（吐出ノズル）を設け、この吐出部を移動しながら液滴を配置するようにし

たので、複数の膜パターン（配線パターン）を短時間で形成できる。

【0011】

本発明のパターンの形成方法において、前記第1パターン形成領域に形成する第1の膜パターンの一方の側部を形成する工程と、前記第1の膜パターンの他方の側部を形成するとともに前記第2パターン形成領域に形成する第2の膜パターンの中央部を形成する工程と、前記第1の膜パターンの中央部を形成するとともに前記第2の膜パターンの一方及び他方のいずれかの側部を形成する工程とを有することを特徴とする。

本発明によれば、第1、第2パターン形成領域のそれぞれについて効率良く幅広い膜パターンを形成することができる。

【0012】

本発明のパターンの形成方法は、液体材料の液滴を基板上に配置することにより膜パターンを形成するパターンの形成方法であって、前記基板上に複数並べて前記膜パターンを形成する際、前記複数の膜パターンのうち、第1の膜パターンの第1領域を形成する第1工程と、前記第1の膜パターンの第2領域を形成するとともに第2の膜パターンの第1領域を形成する第2工程と、前記第1の膜パターンの第3領域を形成するとともに前記第2の膜パターンの第2領域を形成する第3工程とを有することを特徴とする。

本発明によれば、第1の膜パターンと第2の膜パターンとを形成するに際し、形成位置順序すなわち液滴配置順序を互いに異なる順序に設定したので、吐出休止状態の吐出ノズルの数を抑えることができ、高スループット化を図ることができる。

【0013】

本発明のパターンの形成方法において、前記第3工程の後に前記第2の膜パターンの第3領域を形成する第4行程を有することを特徴とする。

本発明によれば、第1及び第2の膜パターンのそれぞれを幅広く形成することができ、電気伝導に有利な膜パターンを形成することができる。

【0014】

本発明のパターンの形成方法において、前記液体材料は導電性微粒子を含む液

状態であることを特徴とする。これにより、導電性を有する配線パターンを形成できる。

【0015】

本発明のパターン形成装置は、液体材料の液滴を基板上に配置する液滴吐出装置を備え、前記液滴により膜パターンを形成するパターン形成装置であって、前記液滴吐出装置は、前記基板上に予め複数並んで設定され前記膜パターンを形成するパターン形成領域のうち、第1パターン形成領域に形成する第1の膜パターンを側部から形成し、第2パターン形成領域に形成する第2の膜パターンを中央部から形成することを特徴とする。

また、本発明のパターン形成装置は、液体材料の液滴を基板上に配置する液滴吐出装置を備え、前記液滴により前記基板上に複数の膜パターンを形成するパターン形成装置であって、前記液滴吐出装置は、第1の膜パターンの第1領域を形成した後、前記第1の膜パターンの第2領域を形成するとともに第2の膜パターンの第1領域を形成し、次いで、前記第1の膜パターンの第3領域を形成するとともに前記第2の膜パターンの第2領域を形成することを特徴とする。

本発明によれば、ノズルピッチとパターンピッチとが互いに異なっても、吐出休止状態の吐出ノズルの数を低減でき、高スループット化を実現できる。

【0016】

本発明のデバイスの製造方法は、配線パターンを有するデバイスの製造方法において、前記基板上に複数並んで設定され前記配線パターンを形成するパターン形成領域のそれぞれに対して液体材料の液滴を配置することにより前記配線パターンを形成する材料配置工程を有し、前記材料配置工程は、前記複数のパターン形成領域のうち、前記配線パターンの側部から形成する第1パターン形成領域と、前記配線パターンの中央部から形成する第2パターン形成領域とを設定し、前記第1、第2パターン形成領域のそれぞれに前記液滴を配置して前記配線パターンを形成することを特徴とする。

また、本発明のデバイスの製造方法は、配線パターンを有するデバイスの製造方法において、液体材料の液滴を基板上に配置することにより複数の配線パターンを形成する材料配置工程を有し、前記材料配置工程は、前記複数の配線パター

ンのうち、第1の配線パターンの第1領域を形成する第1工程と、前記第1の配線パターンの第2領域を形成するとともに第2の配線パターンの第1領域を形成する第2工程と、前記第1の配線パターンの第3領域を形成するとともに前記第2の配線パターンの第2領域を形成する第3工程とを有することを特徴とする。

本発明によれば、ノズルピッチとパターンピッチとが互いに異なっても吐出休止状態の吐出ノズルの数を低減でき、高スループット化を実現できる。そして、幅広の配線パターンを効率良く形成できるので、低コスト化が実現され電気伝導に有利な配線パターンを備えたデバイスを提供できる。

【0017】

本発明の導電膜配線は、上記記載のパターン形成装置により形成されたことを特徴とする。

本発明によれば、低コストで幅広化が実現された電気伝導に有利な導電膜配線を提供できる。

【0018】

本発明の電気光学装置は、上記記載の導電膜配線を備えることを特徴とする。また、本発明の電子機器は、上記記載の電気光学装置を備えることを特徴とする。これらの発明によれば、低コストで電気伝導に有利な導電膜配線を備えるので配線部の断線や短絡等の不良が生じにくい。

【0019】

ここで、電気光学装置としては、例えば、プラズマ型表示装置、液晶表示装置、及び有機エレクトロルミネッセンス表示装置等が挙げられる。

【0020】

上記液滴吐出装置（インクジェット装置）の吐出方式としては、圧電体素子の体積変化により液体材料を配置させるピエゾジェット方式であっても、熱の印加により急激に蒸気が発生することにより液体材料の液滴を配置させる方式であってもよい。

【0021】

液体材料とは、液滴吐出ヘッド（インクジェットヘッド）の吐出ノズルから吐出可能な粘度を備えた媒体をいう。水性であると油性であるとを問わない。ノズ

ル等から吐出可能な流動性（粘度）を備えていれば十分で、固体物質が混入していても全体として流動体であればよい。また、液体材料に含まれる材料は、溶媒中に微粒子として分散されたものの他に、融点以上に加熱されて溶解されたものでもよく、溶媒の他に染料や顔料その他の機能性材料を添加したものであってもよい。また、基板はフラット基板のほか、曲面状の基板であってもよい。さらにパターン形成面の硬度が硬い必要はなく、ガラスやプラスチック、金属以外に、フィルム、紙、ゴム等可撓性を有するものの表面であってもよい。

【 0 0 2 2 】

【発明の実施の形態】

＜パターンの形成方法＞

以下、本発明のパターンの形成方法について図面を参照しながら説明する。図 1 は本発明のパターンの形成方法の一実施形態を示すフローチャート図である。

ここで、本実施形態では基板上に導電膜配線パターンを形成する場合を例にして説明する。

【 0 0 2 3 】

図 1 において、本実施形態に係るパターンの形成方法は、液体材料の液滴が配置される基板を所定の溶媒等を用いて洗浄する工程（ステップ S 1）と、基板の表面処理工程の一部を構成する撥液化処理工程（ステップ S 2）と、撥液化処理された基板表面の撥液性を調整する表面処理工程の一部を構成する撥液性低下処理工程（ステップ S 3）と、表面処理された基板上に液滴吐出法に基づいて導電膜配線形成用材料を含む液体材料の液滴を配置して膜パターンを描画（形成）する材料配置工程（ステップ S 4）と、基板上に配置された液体材料の溶媒成分の少なくとも一部を除去する熱・光処理を含む中間乾燥処理工程（ステップ S 5）と、所定のパターンが描画された基板を焼成する焼成工程（ステップ S 7）とを有している。なお、中間乾燥処理工程の後、所定のパターン描画が終了したかどうか判断され（ステップ S 6）、パターン描画が終了したら焼成工程が行われ、一方、パターン描画が終了していなかったら材料配置工程が行われる。

【 0 0 2 4 】

次に、本発明の特徴部分である液滴吐出法に基づく材料配置工程（ステップ S

4) について説明する。

本実施形態の材料配置工程は、導電膜配線形成用材料を含む液体材料の液滴を液滴吐出装置の液滴吐出ヘッドより基板上に配置することにより基板上に複数の線状の膜パターン（配線パターン）を並べて形成する工程である。液体材料は導電膜配線形成用材料である金属等の導電性微粒子を分散媒に分散した液状体である。以下の説明では、基板 11 上に 2 つの第 1、第 2 の膜パターン W1、W2 を形成する場合について説明する。

【0025】

図 2 において、材料配置工程（ステップ S4）では、まず、基板 11 上に第 1 の膜パターン W1 及び第 2 の膜パターン W2 を形成するパターン形成領域である第 1 パターン形成領域 R1 及び第 2 パターン形成領域 R2 が並べて設定される。そして、第 1 パターン形成領域 R1 ではこの第 1 パターン形成領域 R1 に形成すべき第 1 の膜パターン W1 を線幅方向側部から形成し、第 2 パターン形成領域 R2 ではこの第 2 パターン形成領域 R2 に形成すべき第 2 の膜パターン W2 を線幅方向中央部から形成するように設定される。

【0026】

また、基板 11 上の第 1 パターン形成領域 R1 には、液滴吐出装置の液滴吐出ヘッド 10 に設けられた複数の吐出ノズルのうち第 1 の吐出ノズル 10A より吐出された液体材料の液滴が配置されるように設定されている。一方、基板 11 上の第 2 パターン形成領域 R2 には、第 1 の吐出ノズル 10A とは別の第 2 の吐出ノズル 10B より吐出された液体材料の液滴が配置されるように設定されている。すなわち、第 1、第 2 パターン形成領域 R1、R2 のそれぞれに対応するように吐出ノズル（吐出部）10A、10B が設けられている構成となっている。

【0027】

まず、図 2（a）に示すように、第 1 パターン形成領域 R1 に形成すべき第 1 の膜パターン W1 のうち線幅方向一方の側部である第 1 側部パターン Wa が吐出ノズル 10A より吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド 10 の吐出ノズル 10A から吐出された液体材料の液滴は、基板 11 上に一定の距離間隔（ピッチ）で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより膜パ

ターンW1のパターン形成領域R1の一方の側に、この膜パターンW1の一部を構成する線状の第1側部パターンWaが形成される。このように、図2(a)では第1パターン形成領域R1のみに液滴が配置される。

【0028】

なお、基板11の表面はステップS2及びS3により所望の撥液性に予め加工されているので、基板11上に配置した液滴の拡がりが抑制される。そのためパターン形状を良好な状態に確実に制御できるとともに厚膜化も容易である。

【0029】

ここで、基板11上に第1側部パターンWaを形成するための液滴を配置した後、分散媒の除去を行うために必要に応じて中間乾燥処理（ステップS5）が行われる。中間乾燥処理は、例えばホットプレート、電気炉、及び熱風発生機等の加熱装置を用いた一般的な熱処理の他にランプアニールを用いた光処理であってもよい。

【0030】

次に、図2(b)に示すように、液滴吐出ヘッド10と基板11とが第1、第2パターン形成領域R1、R2の並び方向、すなわちX軸方向に相対移動する。ここでは液滴吐出ヘッド10が+X方向にステップ移動する。これに伴い、吐出ノズル10A、10BもX軸方向に移動する。そして、図2(b)に示すように、第1パターン形成領域R1に形成すべき第1の膜パターンW1のうち線幅方向他方の側部である第2側部パターンWbが吐出ノズル10Aより吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド10の吐出ノズル10Aから吐出された液体材料の液滴は、基板11上に一定の距離間隔（ピッチ）で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより膜パターンW1の第1パターン形成領域R1の他方の側に、この膜パターンW1の一部を構成する線状の第2側部パターンWbが形成される。

【0031】

これと同時に、第2パターン形成領域R2に形成すべき第2の膜パターンW2のうち線幅方向中央部である中央パターンWcが吐出ノズル10Bより吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド10の吐出ノズル10Bから吐出され

た液体材料の液滴は、基板 11 上に一定の距離間隔（ピッチ）で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより第 2 パターン形成領域 R2 の中央部に膜パターン W2 の一部を構成する線状の中央パターン Wc が形成される。このように、図 2（b）では第 1、第 2 パターン形成領域 R1、R2 のそれぞれに対して液滴が同時に配置される。

【0032】

ここでも基板 11 上に第 1 パターン形成領域 R1 の第 2 側部パターン Wb 及び第 2 パターン形成領域 R2 の中央パターン Wc を形成するための液滴を配置した後、分散媒の除去を行うために必要に応じて中間乾燥処理を行うことができる。

【0033】

次に、図 2（c）に示すように、液滴吐出ヘッド 10 が -X 方向にステップ移動する。これに伴い、吐出ノズル 10A、10B も -X 方向に移動する。そして、図 2（c）に示すように、第 1 パターン形成領域 R1 に形成すべき第 1 の膜パターン W1 のうち線幅方向中央部である中央パターン Wc が吐出ノズル 10A より吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド 10 の吐出ノズル 10A から吐出された液体材料の液滴は、基板 11 上に一定の距離間隔（ピッチ）で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより第 1 パターン形成領域 R1 の中央部に線状の中央パターン Wc が形成される。中央パターン Wc を形成するための液滴を配置したことにより、第 1 側部パターン Wa と第 2 側部パターン Wb との間の凹部が液滴（液体材料）で満たされ、これにより第 1 側部パターン Wa と第 2 側部パターン Wb とが一体化されて第 1 の膜パターン W1 が形成される。

【0034】

これと同時に、第 2 パターン形成領域 R2 に形成すべき第 2 の膜パターン W2 のうち線幅方向一方の側部である第 1 側部パターン Wa が吐出ノズル 10B より吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド 10 の吐出ノズル 10B から吐出された液体材料の液滴は、基板 11 上に一定の距離間隔（ピッチ）で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより第 2 パターン形成領域 R2 の中央部に線状の第 1 側部パターン Wa が形成される。このように、図 2（

c) では第 1、第 2 パターン形成領域 R 1、R 2 のそれぞれに対して液滴が同時に配置される。

【0035】

ここで、中央パターン W c に対して一方の側に隣接する線状の第 1 側部パターン W a を形成するに際し、配置した液滴と基板 1 1 上に形成された中央パターン W c との少なくとも一部が重なるように、液滴が配置される。これにより中央パターン W c と第 1 側部パターン W a を形成する液滴とは確実に接続され、形成された膜パターン W 2 に導電膜形成用材料の不連続部が生じることがない。

【0036】

そして、ここでも基板 1 1 上に第 1 パターン形成領域 R 1 の中央パターン W c 及び第 2 パターン形成領域 R 2 の第 1 側部パターン W a を形成するための液滴を配置した後、分散媒の除去を行うために必要に応じて中間乾燥処理が行われる。

【0037】

次に、図 2 (d) に示すように、液滴吐出ヘッド 1 0 が + X 方向にステップ移動する。これに伴い、吐出ノズル 1 0 A、1 0 B も - X 方向に移動する。そして、図 2 (d) に示すように、第 2 パターン形成領域 R 2 に形成すべき第 2 の膜パターン W 2 のうち線幅方向他方の側部である第 2 側部パターン W b が吐出ノズル 1 0 B より吐出された液滴により形成される。液滴吐出ヘッド 1 0 の吐出ノズル 1 0 B から吐出された液体材料の液滴は、基板 1 1 上に一定の距離間隔 (ピッチ) で配置される。そして、この液滴の配置動作を繰り返すことにより膜パターン W 2 の第 2 パターン形成領域 R 2 の他方の側に、この膜パターン W 2 の一部を構成する線状の第 2 側部パターン W b が形成される。このように、図 2 (d) では第 2 パターン形成領域 R 2 のみに対して液滴が配置される。

【0038】

ここで、中央パターン W c に対して他方の側に隣接する線状の第 2 側部パターン W b を形成するに際し、吐出した液滴と基板 1 1 上に形成された中央パターン W c との少なくとも一部が重なるように、液滴が吐出される。これにより中央パターン W c と第 2 側部パターン W b を形成する液滴とは確実に接続され、形成された膜パターン W 2 に導電膜形成用材料の不連続部が生じることがない。こうし

て、第2パターン形成領域R2において中央パターンWcと第1、2側部パターンWa、Wbとが一体化され、幅広の第2の膜パターンW2が形成される。

【0039】

次に、図3(a)～(c)を参照しながら、線状の中央パターンWc、及び側部パターンWa、Wbを形成する手順について説明する。

まず、図3(a)に示すように、液滴吐出ヘッド10から吐出した液滴L1が所定の間隔をあけて基板11上に順次配置される。すなわち、液滴吐出ヘッド10は基板11上で液滴L1どうしが重ならないように配置する。本例では、液滴L1の配置ピッチP1は基板11上に配置した直後の液滴L1の直径よりも大きくなるように設定されている。これにより基板11上に配置された直後の液滴L1どうしは重ならず（接触せずに）、液滴L1どうしが合体して基板11上で濡れ広がることが防止される。また、液滴L1の配置ピッチP1は基板11上に配置した直後の液滴L1の直径の2倍以下となるように設定されている。

【0040】

ここで、基板11上に液滴L1を配置した後、分散媒の除去を行うために必要に応じて中間乾燥処理（ステップS5）を行うことができる。中間乾燥処理は、例えばホットプレート、電気炉、及び熱風発生機等の加熱装置を用いた一般的な熱処理の他に、ランプアニールを用いた光処理であってもよい。

【0041】

次に、図3(b)に示すように、上述した液滴の配置動作が繰り返される。すなわち図3(a)に示した前回と同様に、液滴吐出ヘッド10から液体材料が液滴L2として吐出され、その液滴L2が一定距離ごとに基板11に配置される。このとき、液滴L2の体積（1つの液滴あたりの液体材料の量）、及びその配置ピッチP2は前回の液滴L1と同じである。そして、液滴L2の配置位置は前回の液滴L1から1/2ピッチだけシフトされ、基板11上に配置されている前回の液滴L1どうしの中間位置に今回の液滴L2が配置される。

【0042】

前述したように、基板11上の液滴L1の配置ピッチP1は、基板11上に配置した直後の液滴L1の直径よりも大きく且つ、その直径の2倍以下である。そ

のため、液滴 L 1 の中間位置に液滴 L 2 が配置されることにより、液滴 L 1 に液滴 L 2 が一部重なり、液滴 L 1 どうしの間の隙間が埋まる。このとき、今回の液滴 L 2 と前回の液滴 L 1 とが接するが、前回の液滴 L 1 はすでに分散媒が完全に又はある程度除去されているので、両者が合体して基板 1 1 上で広がることは少ない。

【0043】

なお、図 3 (b) では、液滴 L 2 の配置を開始する位置を前回と同じ側（図 3 (a) に示す左側）としているが逆側（右側）としてもよい。往復動作の各方向への移動時に、液滴の配置を行うことにより、液滴吐出ヘッド 1 0 と基板 1 1 との相対移動の距離を少なくできる。

【0044】

液滴 L 2 を基板 1 1 上に配置した後、分散媒の除去を行うために前回と同様に必要に応じて乾燥処理を行うことができる。

【0045】

こうした一連の液滴の配置動作を複数回繰り返すことにより、基板 1 1 上に配置される液滴どうしの隙間が埋まり、図 3 (c) に示すように、線状の連続したパターンである中央パターン W c、及び側部パターン W a、W b が基板 1 1 上に形成される。この場合、液滴の配置動作の繰り返し回数を増やすことにより基板 1 1 上に液滴が順次重なり、線状のパターン W a、W b、W c の膜厚、すなわち基板 1 1 の表面からの高さ（厚み）が増す。パターン W a、W b、W c の高さ（厚み）は最終的な膜パターンに必要とされる所望の膜厚に応じて設定され、この設定した膜厚に応じて上記液滴の配置動作の繰り返し回数が設定される。

【0046】

なお、線状パターンの形成方法は、図 3 (a) ～ (c) に示したものに限定されない。例えば、液滴の配置ピッチや繰り返しの際のシフト量などは任意に設定可能であり、パターン W a、W b、W c を形成する際の液滴の基板 P 上での配置ピッチをそれぞれ異なる値に設定してもよい。例えば、中央パターン W c を形成する際の液滴ピッチが P 1 である場合、側部パターン W a、W b を形成する際の液滴ピッチを P 1 より広いピッチとしてもよい。もちろん、P 1 より狭いピッチ

としてもよい。また、パターンW_a、W_b、W_cを形成する際の液滴の体積をそれぞれ異なる値に設定してもよい。あるいは、各吐出動作において基板11や液滴吐出ヘッド10が配置される雰囲気である液滴吐出雰囲気（温度や湿度等）を互いに異なる条件に設定してもよい。

【0047】

なお、本実施形態では複数の側部パターンW_a、W_bは1本ずつ形成されるが2本同時に形成されてもよい。なお、1本ずつ複数のパターンW_a、W_bを形成する場合と2本同時に形成する場合とでは乾燥処理の回数の合計が異なる可能性があるため、基板11の撥液性が損なわれないように乾燥条件を定めるとよい。

【0048】

次に、図4～図7を参照しながら基板上に液滴を配置する順序の一例について説明する。これらの図に示すように、基板11上には液体材料の液滴が配置される格子状の複数の単位領域であるピクセルを有するビットマップが設定されている。液滴吐出ヘッド10は液滴をビットマップで設定されたピクセル位置に対して配置する。ここで、1つのピクセルは正方形に設定されている。また、液滴吐出ヘッド10は基板11に対してY軸方向に走査しながら吐出ノズル10A、10Bより液滴を吐出するものとする。そして、図4～図7を用いた説明において、1回目の走査時に配置された液滴には「1」を付し、2回目、3回目、…、n回目の走査時に配置された液滴には「2」、「3」…、「n」を付す。また、以下の説明では、図4のグレーで示す領域（第1及び第2パターン形成領域R1、R2）のそれぞれに液滴を配置して第1及び第2の膜パターンW1、W2を形成するものとする。

【0049】

図4（a）に示すように、1回目の走査時において、第1パターン形成領域R1の第1側部パターンW_aを形成するために第1側部パターン形成予定領域に1つ分のピクセルをあけつつ第1の吐出ノズル10Aより液滴が配置される。ここで、基板11に対して配置された液滴は基板11に着弾することにより基板11上で濡れ広がる。つまり、図4（a）に円で示すように、基板11に着弾した液滴は1つのピクセルの大きさより大きい直径cを有するように濡れ広がる。こ

で、液滴はY軸方向において所定間隔（1つ分のピクセル）をあけて配置されているので、基板11上に配置された液滴どうしは重ならないように設定されている。こうすることによりY軸方向において基板11上に液体材料が過剰に設けられることを防ぎ、バルジの発生を防止することができる。

【0050】

なお、図4（a）では基板11に配置された際の液滴どうしは重ならないように配置されているが、僅かに重なるように液滴が配置されてもよい。また、ここでは1つ分のピクセルをあけて液滴が配置されているが、2つ以上の任意の数のピクセル分だけ間隔をあけて液滴を配置してもよい。この場合、基板11に対する液滴吐出ヘッド10の走査動作及び配置動作（吐出動作）を増やして基板上の液滴どうしの間を補間すればよい。

【0051】

ここで、図4に示す状態では、第2の吐出ノズル10Bは第2パターン形成領域R2に対してずれた位置にあるため、第2の吐出ノズル10Bから液滴は吐出されない。すなわち、図4に示す状態において第2の吐出ノズル10Bは吐出休止状態となっている。

【0052】

図4（b）は2回目の走査により液滴吐出ヘッド10から基板11に液滴を配置した際の模式図である。なお、図4（b）において、2回目の走査時で配置された液滴には「2」を付している。2回目の走査時では、1回目の走査時で配置された液滴「1」の間を補間するように第1の吐出ノズル10Aより液滴が配置される。そして、1回目及び2回目の走査及び配置動作で液滴どうしが連続し、第1の膜パターンW1の第1側部パターン（第1領域）Waが形成される（第1行程）。

【0053】

次に、液滴吐出ヘッド10と基板11とが2つのピクセルの大きさ分だけX軸方向に相対移動する。ここでは液滴吐出ヘッド10が基板11に対して+X方向に2つのピクセル分だけステップ移動する。これに伴って吐出ノズル10A、10Bも移動する。そして、液滴吐出ヘッド10は3回目の走査を行う。これによ

り、図5（a）に示すように、第1の膜パターンW1の一部を構成する第2側部パターンWbを形成するための液滴「3」が第1の吐出ノズル10Aより第1側部パターンWaに対してX軸方向に間隔をあけて基板11上に配置される。ここでも、液滴「3」はY軸方向に1つ分のピクセルをあけて配置される。これと同時に、第2の膜パターンW2の一部を構成する中央パターンWcを形成するための液滴「3」が第2の吐出ノズル10Bより基板11上の第2パターン形成領域R2のうち中央パターン形成予定領域に配置される。ここでも、液滴「3」はY軸方向に1つ分のピクセルをあけて配置される。

【0054】

図5（b）は4回目の走査により液滴吐出ヘッド10から基板11に液滴を配置した際の模式図である。なお、図5（b）において、4回目の走査時で配置された液滴には「4」を付している。4回目の走査時では、3回目の走査時で配置された液滴「3」の間を補間するように第1、第2吐出ノズル10A、10Bより液滴が配置される。そして、3回目及び4回目の走査及び配置動作で液滴どうしが連続し、第1の膜パターンW1の第2側部パターン（第2領域）Wbが形成されるとともに第2の膜パターンW2の中央パターン（第1領域）Wcが形成される（第2工程）。

【0055】

次に、液滴吐出ヘッド10が基板に対して-X方向に1つのピクセル分だけステップ移動し、これに伴って吐出ノズル10A、10Bも-X方向に1つのピクセル分だけ移動する。そして、液滴吐出ヘッド10は5回目の走査を行う。これにより、図6（a）に示すように、第1の膜パターンW1の一部を構成する中央パターンWcを形成するための液滴「5」が基板上に配置される。ここでも、液滴「5」はY軸方向に1つ分のピクセルをあけて配置される。これと同時に、第2の膜パターンW2の一部を構成する第1側部パターンWaを形成するための液滴「5」が第2の吐出ノズル10Bより基板11上の第2パターン形成領域R2のうち第1側部パターン形成予定領域に配置される。ここでも、液滴「5」はY軸方向に1つ分のピクセルをあけて配置される。

【0056】

図6（b）は6回目の走査により液滴吐出ヘッド10から基板11に液滴を配置した際の模式図である。なお、図6（b）において、6回目の走査時で配置された液滴には「6」を付している。6回目の走査時では、5回目の走査時で配置された液滴「5」の間を補間するように第1、第2吐出ノズル10A、10Bより液滴が配置される。そして、5回目及び6回目の走査及び配置動作で液滴どうしが連続し、第1の膜パターンW1の中央パターン（第3領域）Wcが形成されるとともに第2の膜パターンW2の第1側部パターン（第2領域）Waが形成される（第3工程）。

【0057】

次に、液滴吐出ヘッド10が基板に対して+X方向に2つのピクセル分だけステップ移動し、これに伴って吐出ノズル10A、10Bも+X方向に2つのピクセル分だけ移動する。そして、液滴吐出ヘッド10は7回目の走査を行う。これにより、図7（a）に示すように、第2の膜パターンW2の一部を構成する第2側部パターンWbを形成するための液滴「7」が基板上に配置される。ここでも、液滴「7」はY軸方向に1つ分のピクセルをあけて配置される。このとき、第1の膜パターンW1は完成されているとともに第1の吐出ノズル10Aは第1パターン形成領域R1に対してずれた位置にあるため、第1の吐出ノズル10Aから液滴は吐出されない。すなわち、図7に示す状態において第1の吐出ノズル10Aは吐出休止状態となっている。

【0058】

図7（b）は8回目の走査により液滴吐出ヘッド10から基板11に液滴を配置した際の模式図である。なお、図7（b）において、8回目の走査時で配置された液滴には「8」を付している。8回目の走査時では、7回目の走査時で配置された液滴「7」の間を補間するように第2の吐出ノズル10Bより液滴が配置される。なお、第1の吐出ノズル10Aは吐出休止状態である。そして、7回目及び8回目の走査及び配置動作で液滴どうしが連続し、第2の膜パターンW2の第2側部パターン（第3領域）Wbが形成される（第4工程）。

【0059】

次に、図8～図11を参照してパターンの形成方法の他の実施例について説明

する。ここでは、吐出ノズルが10A～10Jの10個あるものとし、ノズルピッチは4つのピクセル分に設定されている。換言すれば、1つの吐出ノズルのX軸方向における該当格子数は4つである。つまり、基板上において1つの吐出ノズルが液滴を配置可能な範囲（すなわち1つの吐出ノズルが受け持つパターン形成可能領域）はX軸方向において4ピクセル分（4列分）である。例えば、第1の吐出ノズル10Aは図8中、第1列～第4列のピクセル範囲に対して液滴を配置可能であり、第2の吐出ノズル10Bは第5列～第8列のピクセル範囲に対して液滴を配置可能である。同様に、吐出ノズル10Cは第9列～第12列、吐出ノズル10Dは第13列～第16列、…、吐出ノズル10Hは第29列～第32列、吐出ノズル10Iは第33列～第36列、吐出ノズル10Jは第37列～第40列に対して液滴を配置可能である。そして、本実施形態では、設計値上において3つのピクセル分の線幅を有する配線パターン（膜パターン）W1～W5を、配線ピッチが6つのピクセル分で形成する。すなわち、配線パターンを形成するパターン形成領域R1～R5が図8のグレーで示す領域に設定されている。したがって、本実施形態では、第1のパターン形成領域R1には第1の吐出ノズル10Aから吐出される液滴が配置され、第2のパターン形成領域R2には第3の吐出ノズル10Cから吐出される液滴が配置され、第3のパターン形成領域R3には第6の吐出ノズル10Fから吐出される液滴が配置され、第4のパターン形成領域R4には第8の吐出ノズル10Hから吐出される液滴が配置され、第5のパターン形成領域R5には第10の吐出ノズル10Jから吐出される液滴が配置される。

【0060】

図8において、パターン形成領域R1に対して吐出ノズル10Aが位置合わせされており、パターン形成領域R3に対して吐出ノズル10Fが位置合わせされており、パターン形成領域R4に対して吐出ノズル10Hが位置合わせされており、パターン形成領域R5に対して吐出ノズル10Jが位置合わせされている。したがって、パターン形成領域R1、R3、R4、R5に関しては液滴配置可能状態である。一方、パターン形成領域R2に対して位置合わせされた吐出ノズルはない。したがってパターン形成領域R2に関しては液滴配置休止状態となる。

【0061】

そして、図4～図7を参照して説明した手順と同様の手順で、液滴吐出ヘッド10が基板11に対して走査し、吐出ノズル10A、10F、10H、10Jから液滴が吐出される。そして、第1、第2回目の走査により、図8の「1」、「2」で示すように液滴が配置される。これにより、パターン形成領域R1において第1側部パターンW_aが形成され、パターン形成領域R3において第2側部パターンW_bが形成され、パターン形成領域R4において中央パターンW_cが形成され、パターン形成領域R5において第1側部パターンW_aが形成される。

【0062】

次いで、図9に示すように、液滴吐出ヘッド10が+X方向に2つのピクセル分だけステップ移動し、これに伴って吐出ノズル10A～10Jも移動する。図9において、パターン形成領域R1に対して吐出ノズル10Aが位置合わせされており、パターン形成領域R2に対して吐出ノズル10Cが位置合わせされており、パターン形成領域R3に対して吐出ノズル10Eが位置合わせされており、パターン形成領域R5に対して吐出ノズル10Jが位置合わせされている。したがって、パターン形成領域R1、R2、R3、R5に関しては液滴配置可能状態である。一方、パターン形成領域R4に対して位置合わせされた吐出ノズルはない。したがって、パターン形成領域R4に関しては液滴配置休止状態である。

【0063】

そして、液滴吐出ヘッド10が基板11に対して走査し、吐出ノズル10A、10C、10E、10Jから液滴が吐出される。そして、第3、第4回目の走査により、図8の「3」、「4」で示すように液滴が配置される。これにより、パターン形成領域R1において第2側部パターンW_bが形成され、パターン形成領域R2において中央パターンW_cが形成され、パターン形成領域R3において第1側部パターンW_aが形成され、パターン形成領域R5において第2側部パターンW_bが形成される。

【0064】

次いで、図10に示すように、液滴吐出ヘッド10が-X方向に1つのピクセル分だけステップ移動し、これに伴って吐出ノズル10A～10Jも移動する。

図10において、パターン形成領域R1に対して吐出ノズル10Aが位置合わせされており、パターン形成領域R2に対して吐出ノズル10Cが位置合わせされており、パターン形成領域R4に対して吐出ノズル10Hが位置合わせされており、パターン形成領域R5に対して吐出ノズル10Jが位置合わせされている。したがって、パターン形成領域R1、R2、R4、R5に関しては液滴配置可能状態である。一方、パターン形成領域R3に対して位置合わせされた吐出ノズルはない。したがってパターン形成領域R3に関しては液滴配置休止状態である。

【0065】

そして、液滴吐出ヘッド10が基板11に対して走査し、吐出ノズル10A、10C、10H、10Jから液滴が吐出される。そして、第5、第6回目の走査により、図10の「5」、「6」で示すように液滴が配置される。これにより、パターン形成領域R1において中央パターンWcが形成され、パターン形成領域R2において第1側部パターンWaが形成され、パターン形成領域R4において第2側部パターンWbが形成され、パターン形成領域R5において中央パターンWcが形成される。

【0066】

次いで、図11に示すように、液滴吐出ヘッド10が+X方向に2つのピクセル分だけステップ移動し、これに伴って吐出ノズル10A～10Jも移動する。図11において、パターン形成領域R2に対して吐出ノズル10Cが位置合わせされており、パターン形成領域R3に対して吐出ノズル10Eが位置合わせされており、パターン形成領域R4に対して吐出ノズル10Gが位置合わせされている。したがって、パターン形成領域R2、R3、R4に関しては液滴配置可能状態である。一方、パターン形成領域R1、R5に対して位置合わせされた吐出ノズルはない。したがって、パターン形成領域R1、R5に関しては液滴配置休止状態である。なお、この状態においてパターン形成領域R1、R5の膜パターンW1、W5は既に完成されている。

【0067】

そして、液滴吐出ヘッド10が基板11に対して走査し、吐出ノズル10C、10E、10Gから液滴が吐出される。そして、第7、第8回目の走査により、

図11の「7」、「8」で示すように液滴が配置される。これにより、パターン形成領域R2において第2側部パターンWbが形成され、パターン形成領域R3において中央パターンWcが形成され、パターン形成領域R4において第1側部パターンWaが形成される。

【0068】

以上のようにして、第1～第5の膜パターンW1～W5が形成される。そして、本実施形態のように、吐出ノズルピッチと配線パターンピッチとが一致しない状態であっても、本発明のパターン形成方法を適用することにより、図8～図11を用いて説明したように、各走査時のそれぞれにおける液滴配置休止状態となるパターン形成領域を例えば1つだけとすることができる。したがって、複数の膜パターンを短時間で（本実施形態では8回の走査で）効率良く形成することができる。

【0069】

なお、上記実施形態において、導電膜配線用の基板としては、ガラス、石英ガラス、Siウエハ、プラスチックフィルム、金属板など各種のものをを用いることができる。また、これら各種の素材基板の表面に半導体膜、金属膜、誘電体膜、有機膜などが下地層として形成されたものも含む。

【0070】

導電膜配線用の液体材料として、本例では導電性微粒子を分散媒に分散させた分散液（液状体）が用いられ、これは水性であると油性であるとを問わない。ここで用いられる導電性微粒子は、金、銀、銅、パラジウム、及びニッケルのうちのいずれかを含有する金属微粒子の他、導電性ポリマーや超電導体の微粒子などが用いられる。これらの導電性微粒子は、分散性を向上させるために表面に有機物などをコーティングして使うこともできる。導電性微粒子の表面にコーティングするコーティング材としては、例えばキシレン、トルエン等の有機溶剤やクエン酸等が挙げられる。

【0071】

導電性微粒子の粒径は5nm以上0.1μm以下であることが好ましい。0.1μmより大きいと、上記液滴吐出ヘッドのノズルに目詰まりが生じるおそれがある。

ある。また、5 nmより小さいと、導電性微粒子に対するコーティング剤の体積比が大きくなり、得られる膜中の有機物の割合が過多となる。

【0072】

導電性微粒子を含有する液体の分散媒としては、室温での蒸気圧が0.001 mmHg以上200 mmHg以下（約0.133 Pa以上26600 Pa以下）であるものが好ましい。蒸気圧が200 mmHgより高い場合には、配置後に分散媒が急激に蒸発し、良好な膜を形成することが困難となる。また、分散媒の蒸気圧は0.001 mmHg以上50 mmHg以下（約0.133 Pa以上6650 Pa以下）であることがより好ましい。蒸気圧が50 mmHgより高い場合には、インクジェット法で液滴を配置する際に乾燥によるノズル詰まりが起きやすい。一方、室温での蒸気圧が0.001 mmHgより低い分散媒の場合、乾燥が遅くて膜中に分散媒が残留しやすくなり、後工程の熱・光処理後に良質の導電膜が得られにくい。

【0073】

上記分散媒としては、上記の導電性微粒子を分散できるものであって凝集を起こさないものであれば特に限定されない。例えば、水の他に、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルコール類、n-ヘプタン、n-オクタン、デカン、トルエン、キシレン、シメン、デュレン、インデン、ジペンテン、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、シクロヘキシルベンゼンなどの炭化水素系化合物、またエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ビス(2-メトキシエチル)エーテル、p-ジオキサンなどのエーテル系化合物、さらにプロピレンカーボネート、γ-ブチロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、シクロヘキサノンなどの極性化合物を例示できる。これらのうち、微粒子の分散性と分散液の安定性、またインクジェット法への適用の容易さの点で、水、アルコール類、炭化水素系化合物、エーテル系化合物が好ましく、より好ましい分散媒としては、水、炭化水素

系化合物を挙げることができる。これらの分散媒は、単独で使用してもよく、2種以上の混合物として使用してもよい。

【0074】

上記導電性微粒子を分散媒に分散する場合の分散質濃度は1質量%以上80質量%以下であり、所望の導電膜の膜厚に応じて調整するとよい。なお、80質量%を超えると凝集をおこしやすく、均一な膜が得にくい。

【0075】

上記導電性微粒子の分散液の表面張力は0.02 N/m以上0.07 N/m以下の範囲内であることが好ましい。インクジェット法にて液体を配置する際、表面張力が0.02 N/m未満であると、インク組成物のノズル面に対する濡れ性が増大するため飛行曲りが生じやすくなり、0.07 N/mを超えるとノズル先端でのメニスカスの形状が安定しないため配置量や、配置タイミングの制御が困難になる。

【0076】

表面張力を調整するため、上記分散液には、基板との接触角を大きく低下させない範囲で、フッ素系、シリコン系、ノニオン系などの表面張力調節剤を微量添加するとよい。ノニオン系表面張力調節剤は、液体の基板への濡れ性を向上させ、膜のレベリング性を改良し、膜の微細な凹凸の発生などの防止に役立つものである。上記分散液は、必要に応じて、アルコール、エーテル、エステル、ケトン等の有機化合物を含んでもよい。

【0077】

上記分散液の粘度は1 mPa・s以上50 mPa・s以下であることが好ましい。インクジェット法を用いて液体材料を液滴として配置する際、粘度が1 mPa・sより小さい場合にはノズル周辺部がインクの流出により汚染されやすく、また粘度が50 mPa・sより大きい場合は、ノズル孔での目詰まり頻度が高くなり円滑な液滴の配置が困難となる。

【0078】

<表面処理工程>

次に、図1で示した表面処理工程S2、S3について説明する。表面処理工程

では、導電膜配線を形成する基板の表面を液体材料に対して撥液性に加工する（ステップS2）。

具体的には、導電性微粒子を含有した液体材料に対する所定の接触角が、60 [deg] 以上、好ましくは90 [deg] 以上110 [deg] 以下となるように基板に対して表面処理を施す。表面の撥液性（濡れ性）を制御する方法としては、例えば、基板の表面に自己組織化膜を形成する方法、プラズマ処理法等を採用できる。

【0079】

自己組織膜形成法では、導電膜配線を形成すべき基板の表面に、有機分子膜などからなる自己組織化膜を形成する。基板表面を処理するための有機分子膜は、基板に結合可能な官能基と、その反対側に親液基あるいは撥液基といった基板の表面性を改質する（表面エネルギーを制御する）官能基と、これらの官能基を結ぶ炭素の直鎖あるいは一部分岐した炭素鎖とを備えており、基板に結合して自己組織化して分子膜、例えば単分子膜を形成する。

【0080】

ここで、自己組織化膜とは、基板の下地層等の構成原子と反応可能な結合性官能基とそれ以外の直鎖分子とからなり、直鎖分子の相互作用により極めて高い配向性を有する化合物を、配向させて形成された膜である。この自己組織化膜は、単分子を配向させて形成されているので、極めて膜厚を薄くすることができ、しかも、分子レベルで均一な膜となる。すなわち、膜の表面に同じ分子が位置するため、膜の表面に均一でしかも優れた撥液性や親液性を付与することができる。

【0081】

上記の高い配向性を有する化合物として、例えばフルオロアルキルシランを用いることにより、膜の表面にフルオロアルキル基が位置するように各化合物が配向されて自己組織化膜が形成され、膜の表面に均一な撥液性が付与される。

【0082】

自己組織化膜を形成する化合物としては、ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2, 2テトラヒドロデシルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2, 2テトラヒドロデシルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2,

2 テトラヒドロデシルトリクロロシラン、トリデカフルオロー 1, 1, 2, 2 テトラヒドロオクチルトリエトキシシラン、トリデカフルオロー 1, 1, 2, 2 テトラヒドロオクチルトリメトキシシラン、トリデカフルオロー 1, 1, 2, 2 テトラヒドロオクチルトリクロロシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン等のフルオロアルキルシラン（以下「FAS」という）を例示できる。これらの化合物は、単独で使用してもよく、2 種以上を組み合わせ使用してもよい。なお、FAS を用いることにより、基板との密着性と良好な撥液性を得ることができる。

【0083】

FAS は、一般的に構造式 $R_n Si X_{(4-n)}$ で表される。ここで n は 1 以上 3 以下の整数を表し、 X はメトキシ基、エトキシ基、ハロゲン原子などの加水分解基である。また R はフルオロアルキル基であり、 $(CF_3)(CF_2)_x(CH_2)_y$ の（ここで x は 0 以上 10 以下の整数を、 y は 0 以上 4 以下の整数を表す）構造を持ち、複数個の R 又は X が Si に結合している場合には、 R 又は X はそれぞれすべて同じでもよく、異なってもよい。 X で表される加水分解基は加水分解によりシラノールを形成して、基板（ガラス、シリコン）の下地のヒドロキシル基と反応してシロキサン結合で基板と結合する。一方、 R は表面に (CF_3) 等のフルオロ基を有するため、基板の下地表面を濡れない（表面エネルギーが低い）表面に改質する。

【0084】

有機分子膜などからなる自己組織化膜は、上記の原料化合物と基板とを同一の密閉容器中に入れておき、室温で 2～3 日程度の間放置することにより基板上に形成される。また、密閉容器全体を 100℃に保持することにより、3 時間程度で基板上に形成される。これらは気相からの形成法であるが、液相からも自己組織化膜を形成できる。例えば、原料化合物を含む溶液中に基板を浸漬し、洗浄、乾燥することで基板上に自己組織化膜が形成される。なお、自己組織化膜を形成する前に、基板表面に紫外光を照射したり、溶媒により洗浄したりして、基板表面の前処理を施すことが望ましい。

【0085】

FAS処理を施した後、所望の撥液性に処理する撥液性低下処理が必要に応じで行われる（ステップS3）。すなわち、撥液化処理としてFAS処理を施した際に、撥液性の作用が強すぎて基板とこの基板上に形成した膜パターンWとが剥離しやすくなる場合がある。そこで、撥液性を低下（調整）する処理が行われる。撥液性を低下する処理としては波長170～400nm程度の紫外線（UV）照射処理が挙げられる。所定のパワーの紫外線を所定時間だけ基板に照射することで、FAS処理された基板の撥液性が低下され、基板は所望の撥液性を有するようになる。あるいは、基板をオゾン雰囲気曝すことにより基板の撥液性を制御することもできる。

【0086】

一方、プラズマ処理法では、常圧又は真空中で基板に対してプラズマ照射を行う。プラズマ処理に用いるガス種は、導電膜配線を形成すべき基板の表面材質等を考慮して種々選択できる。処理ガスとしては、例えば、4フッ化メタン、パーフルオロヘキサン、パーフルオロデカン等が例示できる。

【0087】

なお、基板表面を撥液性に加工する処理は、所望の撥液性を有するフィルム、例えば4フッ化エチレン加工されたポリイミドフィルム等を基板表面に貼着することによっても行ってもよい。また、撥液性の高いポリイミドフィルムをそのまま基板として用いてもよい。

【0088】

<中間乾燥工程>

次に、図1で示した中間乾燥工程S5について説明する。中間乾燥工程（熱・光処理工程）では、基板上に配置された液滴に含まれる分散媒あるいはコーティング材を除去する。すなわち、基板上に配置された導電膜形成用の液体材料は、微粒子間の電氣的接触をよくするために分散媒を完全に除去する必要がある。また、導電性微粒子の表面に分散性を向上させるために有機物などのコーティング材がコーティングされている場合には、このコーティング材も除去する必要がある。

【0089】

熱・光処理は通常大気中で行なわれるが、必要に応じて、窒素、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気中に行ってもよい。熱・光処理の処理温度は、分散媒の沸点（蒸気圧）、雰囲気ガスの種類や圧力、微粒子の分散性や酸化性等の熱的挙動、コーティング材の有無や量、基材の耐熱温度などを考慮して適宜決定される。例えば有機物からなるコーティング材を除去するためには、約300℃で焼成することが必要である。また、プラスチックなどの基板を使用する場合には、室温以上100℃以下で行なうことが好ましい。

【0090】

熱処理には、例えばホットプレート、電気炉等の加熱装置を用いることができる。光処理にはランプアニールを用いることができる。ランプアニールに使用する光の光源としては、特に限定されないが、赤外線ランプ、キセノンランプ、YAGレーザ、アルゴンレーザ、炭酸ガスレーザ、XeF、XeCl、XeBr、KrF、KrCl、ArF、ArClなどのエキシマレーザーなどを使用することができる。これらの光源は一般には、出力10W以上5000W以下の範囲のものが用いられるが、本実施形態例では100W以上1000W以下の範囲で十分である。上記熱・光処理により微粒子間の電氣的接触が確保され、導電膜に変換される。

【0091】

なお、この際、分散媒の除去だけでなく、分散液を導電膜に変換するまで、加熱や光照射の度合いを高めても差し支えない。ただし、導電膜の変換は、すべての液体材料の配置が終了してから、熱処理・光処理工程においてまとめて行えばよいので、ここでは、分散媒をある程度除去できれば十分である。例えば、熱処理の場合は、通常100℃程度の加熱を数分行えばよい。また、乾燥処理は液体材料の配置と並行して同時に進行させることも可能である。例えば、基板を予め加熱しておいたり、液滴吐出ヘッドの冷却とともに沸点の低い分散媒を使用したりすることにより、基板に液滴を配置した直後から、その液滴の乾燥を進行させることができる。

【0092】

以上説明した一連の工程により、基板上に線状の導電膜パターンが形成される

。本例の配線形成方法では、一度に形成可能な線状パターンの線幅に制限がある場合にも、複数の線状パターンを形成しそれを一体化することにより、線状パターンの幅広化を達成できる。そのため、電気伝導に有利で、しかも配線部の断線や短絡等の不具合が生じにくい導電膜パターンを形成できる。

【0093】

＜パターン形成装置＞

次に、本発明のパターン形成装置の一例について説明する。図12は本実施形態に係るパターン形成装置の概略斜視図である。図12に示すように、パターン形成装置100は、液滴吐出ヘッド10、液滴吐出ヘッド10をX方向に駆動するためのX方向ガイド軸2、X方向ガイド軸2を回転させるX方向駆動モータ3、基板11を載置するための載置台4、載置台4をY方向に駆動するためのY方向ガイド軸5、Y方向ガイド軸5を回転させるY方向駆動モータ6、クリーニング機構部14、ヒータ15、及びこれらを統括的に制御する制御装置8等を備えている。X方向ガイド軸2及びY方向ガイド軸5はそれぞれ、基台7上に固定されている。なお、図12では、液滴吐出ヘッド10は、基板11の進行方向に対し直角に配置されているが、液滴吐出ヘッド10の角度を調整し、基板11の進行方向に対して交差させるようにしてもよい。このようにすれば、液滴吐出ヘッド10の角度を調整することで、ノズル間のピッチを調節することが出来る。また、基板11とノズル面との距離を任意に調節することが出来るようにしてもよい。

【0094】

液滴吐出ヘッド10は、導電性微粒子を含有する分散液からなる液体材料を吐出ノズルから吐出するものであり、X方向ガイド軸2に固定されている。X方向駆動モータ3はステッピングモータ等であり、制御装置8からX軸方向の駆動パルス信号が供給されると、X方向ガイド軸2を回転させる。X方向ガイド軸2の回転により、液滴吐出ヘッド10が基台7に対してX軸方向に移動する。

【0095】

液滴吐出方式としては、圧電体素子であるピエゾ素子を用いてインクを吐出させるピエゾ方式、液体材料を加熱し発生した泡（バブル）により液体材料を吐出

させるバブル方式など、公知の様々な技術を適用できる。このうち、ピエゾ方式は、液体材料に熱を加えないため、材料の組成等に影響を与えないという利点を有する。なお、本例では、液体材料選択の自由度の高さ、及び液滴の制御性の良さの点から上記ピエゾ方式を用いる。

【0096】

載置台 4 は Y 方向ガイド軸 5 に固定され、Y 方向ガイド軸 5 には、Y 方向駆動モータ 6、16 が接続されている。Y 方向駆動モータ 6、16 は、ステッピングモータ等であり、制御装置 8 から Y 軸方向の駆動パルス信号が供給されると、Y 方向ガイド軸 5 を回転させる。Y 方向ガイド軸 5 の回転により、載置台 4 が基台 7 に対して Y 軸方向に移動する。クリーニング機構部 14 は、液滴吐出ヘッド 10 をクリーニングし、ノズルの目詰まりなどを防ぐものである。クリーニング機構部 14 は、上記クリーニング時において、Y 方向の駆動モータ 16 によって Y 方向ガイド軸 5 に沿って移動する。ヒータ 15 は、ランプアニール等の加熱手段を用いて基板 11 を熱処理するものであり、基板 11 上に配置された液体の蒸発・乾燥を行うとともに導電膜に変換するための熱処理を行う。

【0097】

本実施形態のパターン形成装置 100 では、液滴吐出ヘッド 10 から液体材料を吐出しながら、X 方向駆動モータ 3 及び Y 方向駆動モータ 6 を介して、基板 11 と液滴吐出ヘッド 10 とを相対移動させることにより、基板 11 上に液体材料を配置する。液滴吐出ヘッド 10 の各ノズルからの液滴の吐出量は、制御装置 8 から上記ピエゾ素子に供給される電圧によって制御される。また、基板 11 上に配置される液滴のピッチは、上記相対移動の速度、及び液滴吐出ヘッド 10 からの配置周波数（ピエゾ素子への駆動電圧の周波数）によって制御される。また、基板 11 上に液滴を開始する位置は、上記相対移動の方向、及び上記相対移動時における液滴吐出ヘッド 10 からの液滴の配置開始のタイミング制御等によって制御される。これにより、基板 11 上に上述した配線用の導電膜パターンが形成される。

【0098】

<電気光学装置>


次に、本発明の電気光学装置の一例としてプラズマ型表示装置について説明する。図13は本実施形態のプラズマ型表示装置500の分解斜視図を示している。プラズマ型表示装置500は、互いに対向して配置された基板501、502、及びこれらの間に形成される放電表示部510を含んで構成される。放電表示部510は、複数の放電室516が集合されたものである。複数の放電室516のうち、赤色放電室516（R）、緑色放電室516（G）、青色放電室516（B）の3つの放電室516が対になって1画素を構成するように配置されている。

【0099】

基板501の上面には所定の間隔でストライプ状にアドレス電極511が形成され、アドレス電極511と基板501の上面とを覆うように誘電体層519が形成されている。誘電体層519上には、アドレス電極511、511間に位置しかつ各アドレス電極511に沿うように隔壁515が形成されている。隔壁515は、アドレス電極511の幅方向左右両側に隣接する隔壁と、アドレス電極511と直交する方向に延設された隔壁とを含む。また、隔壁515によって仕切られた長形状の領域に対応して放電室516が形成されている。また、隔壁515によって区画される長形状の領域の内側には蛍光体517が配置されている。蛍光体517は、赤、緑、青の何れかの蛍光を発光するもので、赤色放電室516（R）の底部には赤色蛍光体517（R）が、緑色放電室516（G）の底部には緑色蛍光体517（G）が、青色放電室516（B）の底部には青色蛍光体517（B）が各々配置されている。

【0100】

一方、基板502には、先のアドレス電極511と直交する方向に複数の表示電極512がストライプ状に所定の間隔で形成されている。さらに、これらを覆うように誘電体層513、及びMgOなどからなる保護膜514が形成されている。基板501と基板502とは、前記アドレス電極511…と表示電極512…を互いに直交させるように対向させて相互に貼り合わされている。上記アドレス電極511と表示電極512は図示略の交流電源に接続されている。各電極に通電することにより、放電表示部510において蛍光体517が励起発光し、カ



ラ表示が可能となる。

【0101】

本実施形態では、上記アドレス電極 511、及び表示電極 512 がそれぞれ、先の図 12 に示したパターン形成装置を用いて、先の図 1 ～図 11 に示したパターンの形成方法に基づいて形成されている。そのため、上記各配線類の断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、高スループットに製造できる。

【0102】

次に、本発明の電気光学装置の他の例として液晶装置について説明する。図 14 は本実施形態に係る液晶装置の第 1 基板上の信号電極等の平面レイアウトを示すものである。本実施形態に係る液晶装置は、この第 1 基板と、走査電極等が設けられた第 2 基板（図示せず）と、第 1 基板と第 2 基板との間に封入された液晶（図示せず）とから概略構成されている。

【0103】

図 14 に示すように、第 1 基板 300 上の画素領域 303 には、複数の信号電極 310…が多重マトリクス状に設けられている。特に各信号電極 310…は、各画素に対応して設けられた複数の画素電極部分 310a…とこれらを多重マトリクス状に接続する信号配線部分 310b…とから構成されており、Y 方向に伸延している。また、符号 350 は 1 チップ構造の液晶駆動回路で、この液晶駆動回路 350 と信号配線部分 310b…の一端側（図中下側）とが第 1 引き回し配線 331…を介して接続されている。また、符号 340…は上下導通端子で、この上下導通端子 340…と、図示しない第 2 基板上に設けられた端子とが上下導通材 341…によって接続されている。また、上下導通端子 340…と液晶駆動回路 350 とが第 2 引き回し配線 332…を介して接続されている。

【0104】

本実施形態例では、上記第 1 基板 300 上に設けられた信号配線部分 310b…、第 1 引き回し配線 331…、及び第 2 引き回し配線 332…がそれぞれ、先の図 12 に示したパターン形成装置を用いて、先の図 1 ～図 11 に示したパターンの形成方法に基づいて形成されている。そのため、上記各配線類の断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、高スループットに製造できる。また、大型化し

た液晶用基板の製造に適用した場合においても、配線用材料を効率的に使用することができ、低コスト化が図れる。なお、本発明が適用できるデバイスは、これらの電気光学装置に限られず、例えば導電膜配線が形成される回路基板や、半導体の実装配線等、他のデバイス製造にも適用が可能である。

【0105】

<電子機器>

次に、本発明の電子機器の例について説明する。図15は上述した実施形態に係る表示装置を備えたモバイル型のパーソナルコンピュータ（情報処理装置）の構成を示す斜視図である。同図において、パーソナルコンピュータ1100は、キーボード1102を備えた本体部1104と、上述した電気光学装置1106を備えた表示装置ユニットとから構成されている。このため、発光効率が高く明るい表示部を備えた電子機器を提供することができる。

【0106】

なお、上述した例に加えて、他の例として、携帯電話、腕時計型電子機器、液晶テレビ、ビューファインダ型やモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、電子ペーパー、タッチパネルを備えた機器等が挙げられる。本発明の電気光学装置は、こうした電子機器の表示部としても適用できる。なお、本実施形態の電子機器は液晶装置を備えるもの、有機エレクトロルミネッセンス表示装置、プラズマ型表示装置等、他の電気光学装置を備えた電子機器とすることもできる。

【0107】

以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のパターンの形成方法の一実施形態を示すフローチャート図である。

【図 2】 本発明のパターンの形成方法の一実施形態を示す模式図である。

【図 3】 本発明のパターンの形成方法の一実施形態を示す模式図である。

【図 4】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子を示す模式図である。

【図 5】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子を示す模式図である。

【図 6】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子を示す模式図である。

【図 7】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子を示す模式図である。

【図 8】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子の他の実施例を示す模式図である。

【図 9】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子の他の実施例を示す模式図である。

【図 1 0】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子の他の実施例を示す模式図である。

【図 1 1】 基板上に設定されたビットマップデータに基づいて液滴が配置される様子の他の実施例を示す模式図である。

【図 1 2】 本発明のパターン形成装置の一実施形態を示す概略斜視図である。

【図 1 3】 本発明の電気光学装置の一実施形態を示す図であってプラズマ型表示装置に適用した例を示す分解斜視図である。

【図 1 4】 本発明の電気光学装置の一実施形態を示す図であって液晶装置に適用した例を示す平面図である。

【図 1 5】 本発明の電子機器の一実施形態を示す図である。

【符号の説明】

- 1 0…液滴吐出ヘッド（液滴吐出装置）、
- 1 0 A～1 0 J…吐出ノズル（吐出部）、1 1…基板、
- 1 0 0…パターン形成装置（液滴吐出装置）、
- R 1～R 5…パターン形成領域、

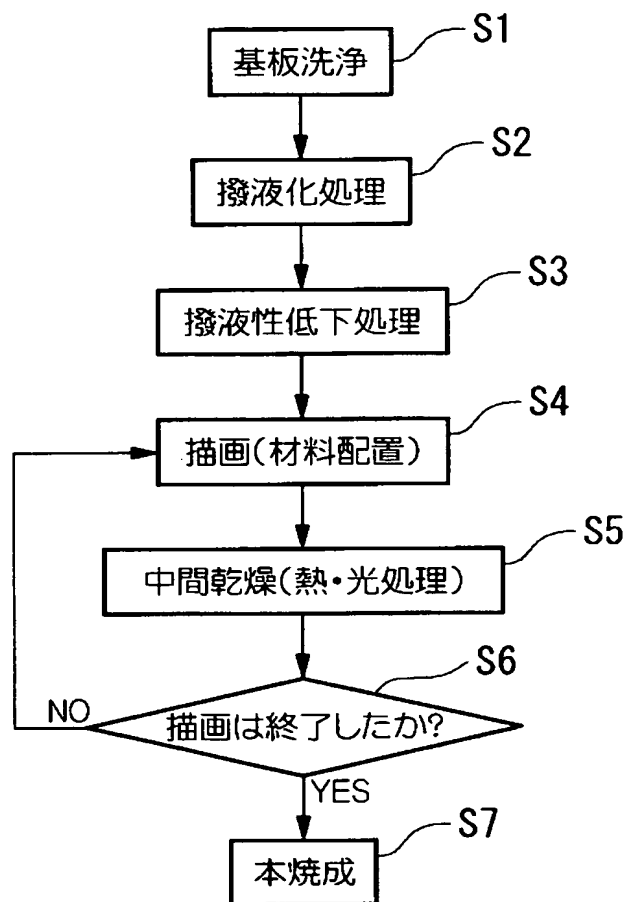
W 1 ～ W 5 …膜パターン（配線パターン、導電膜配線）、

W a …第 1 側部パターン（一方の側部）、

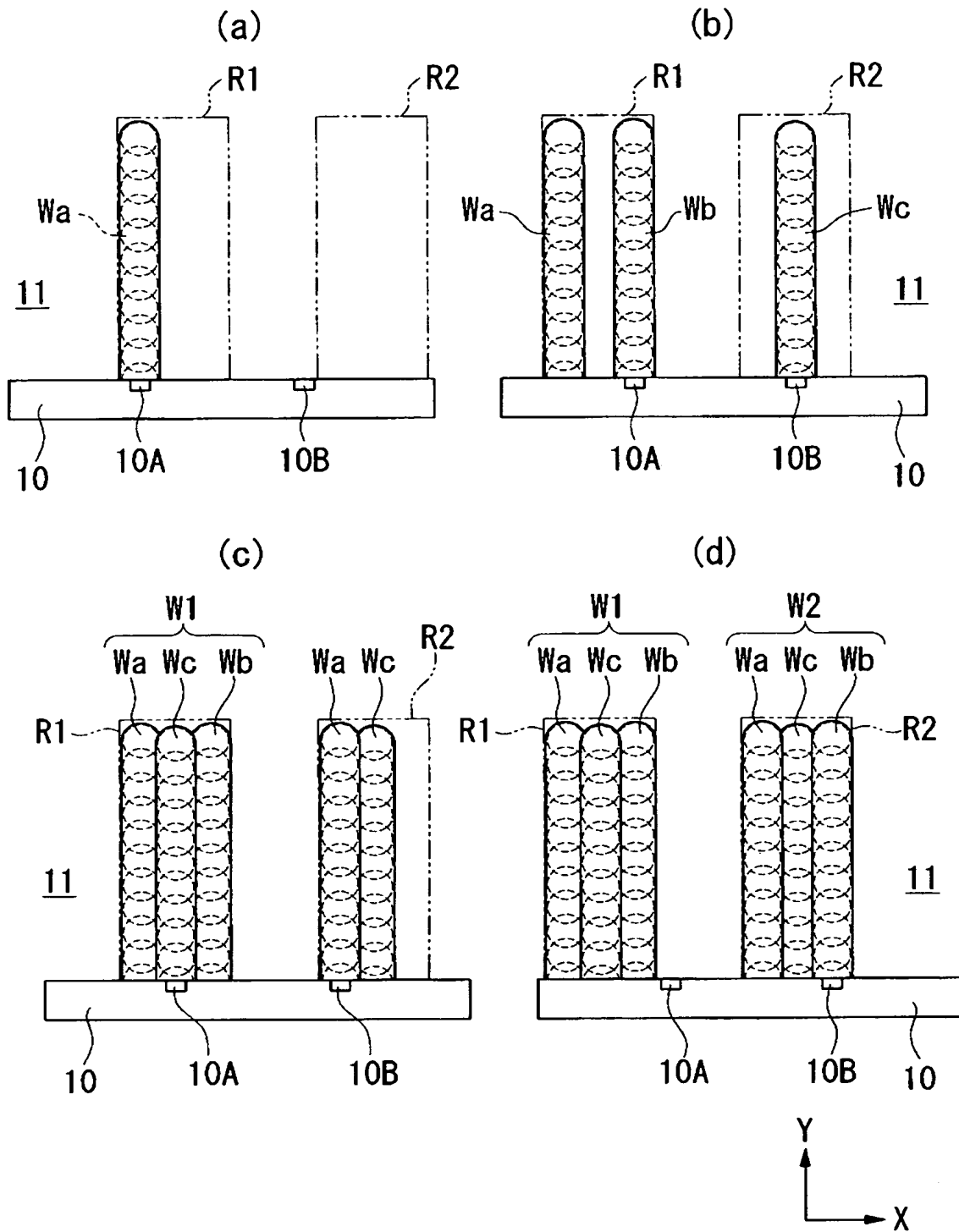
W b …第 2 側部パターン（他方の側部）、W c …中央パターン（中央部）

【書類名】 図面

【図 1】

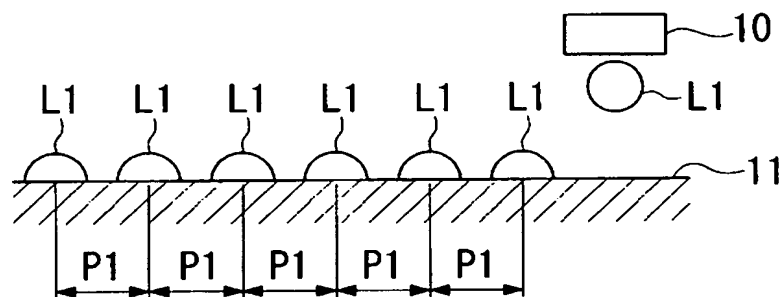


【図 2】

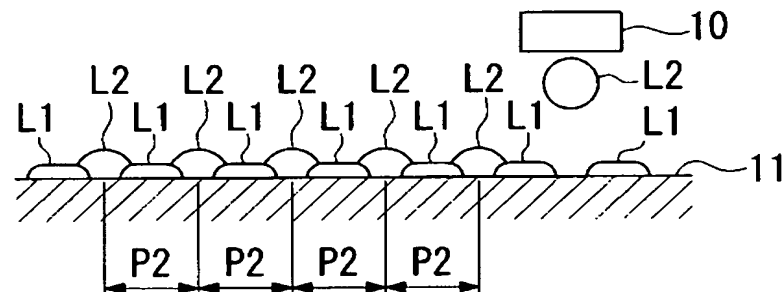


【図 3】

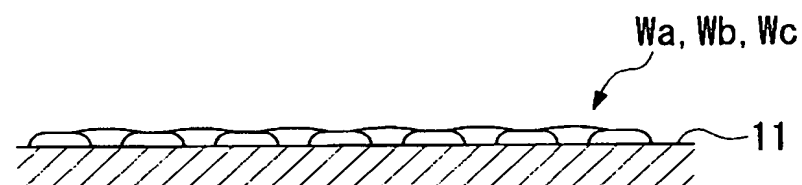
(a)



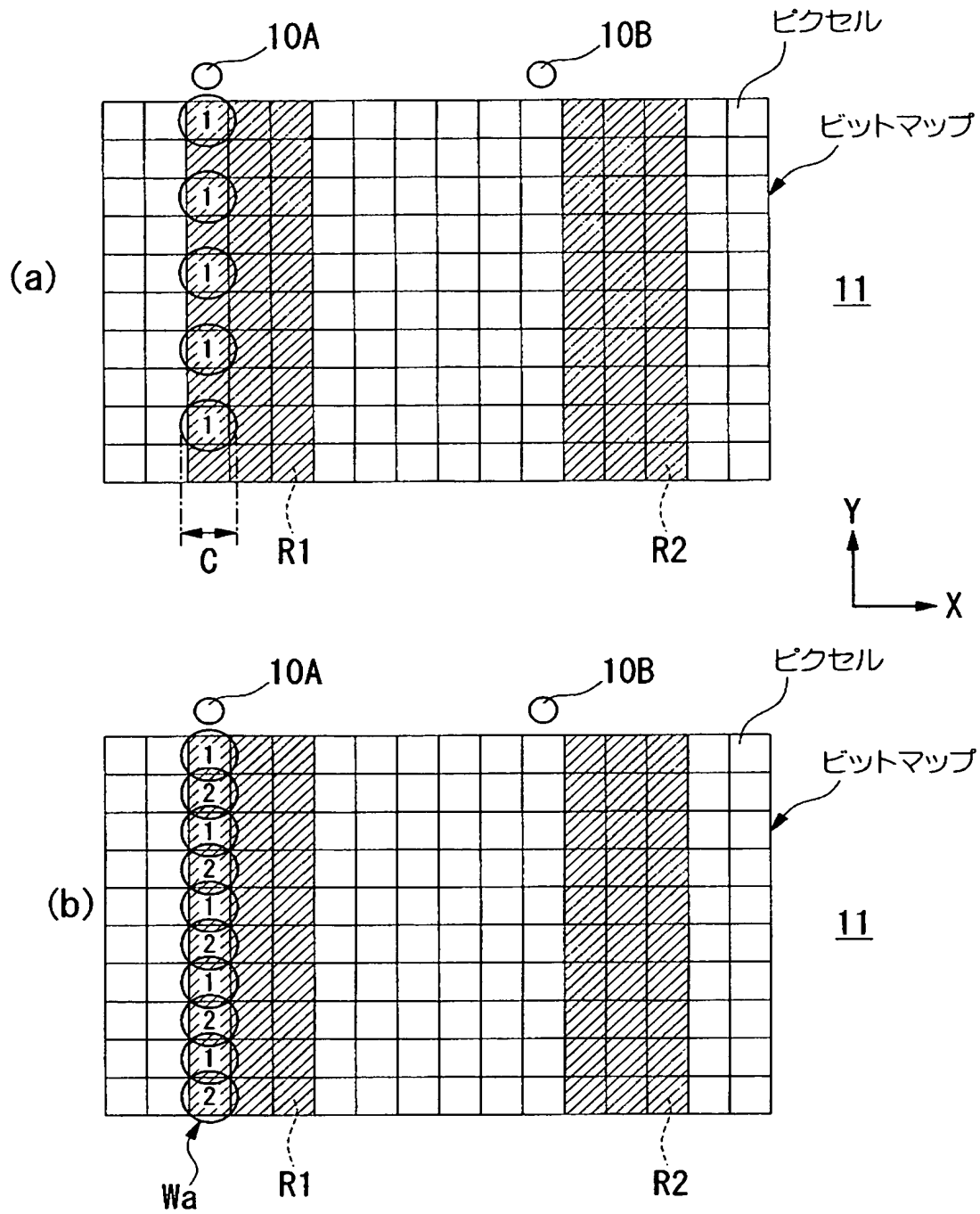
(b)



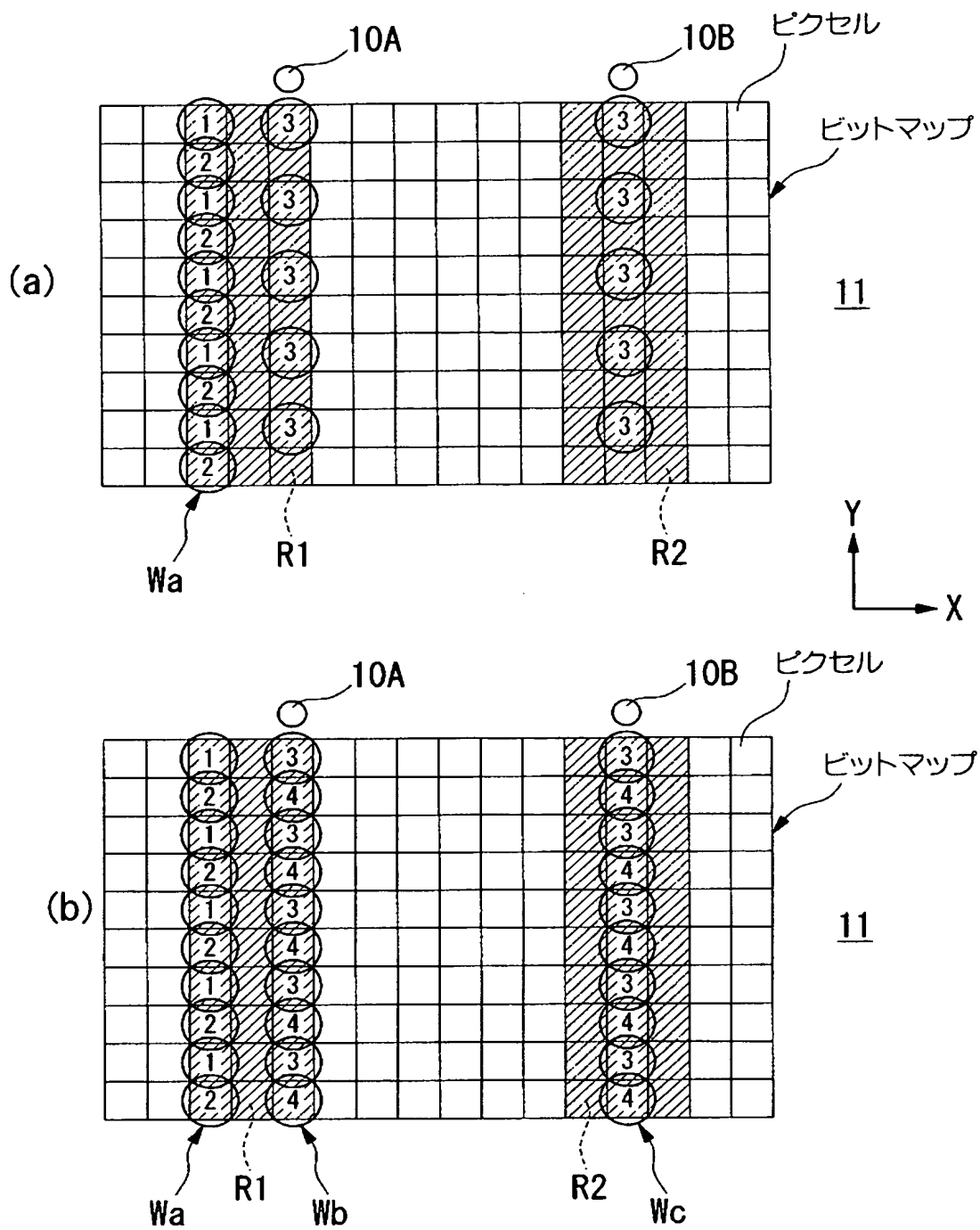
(c)



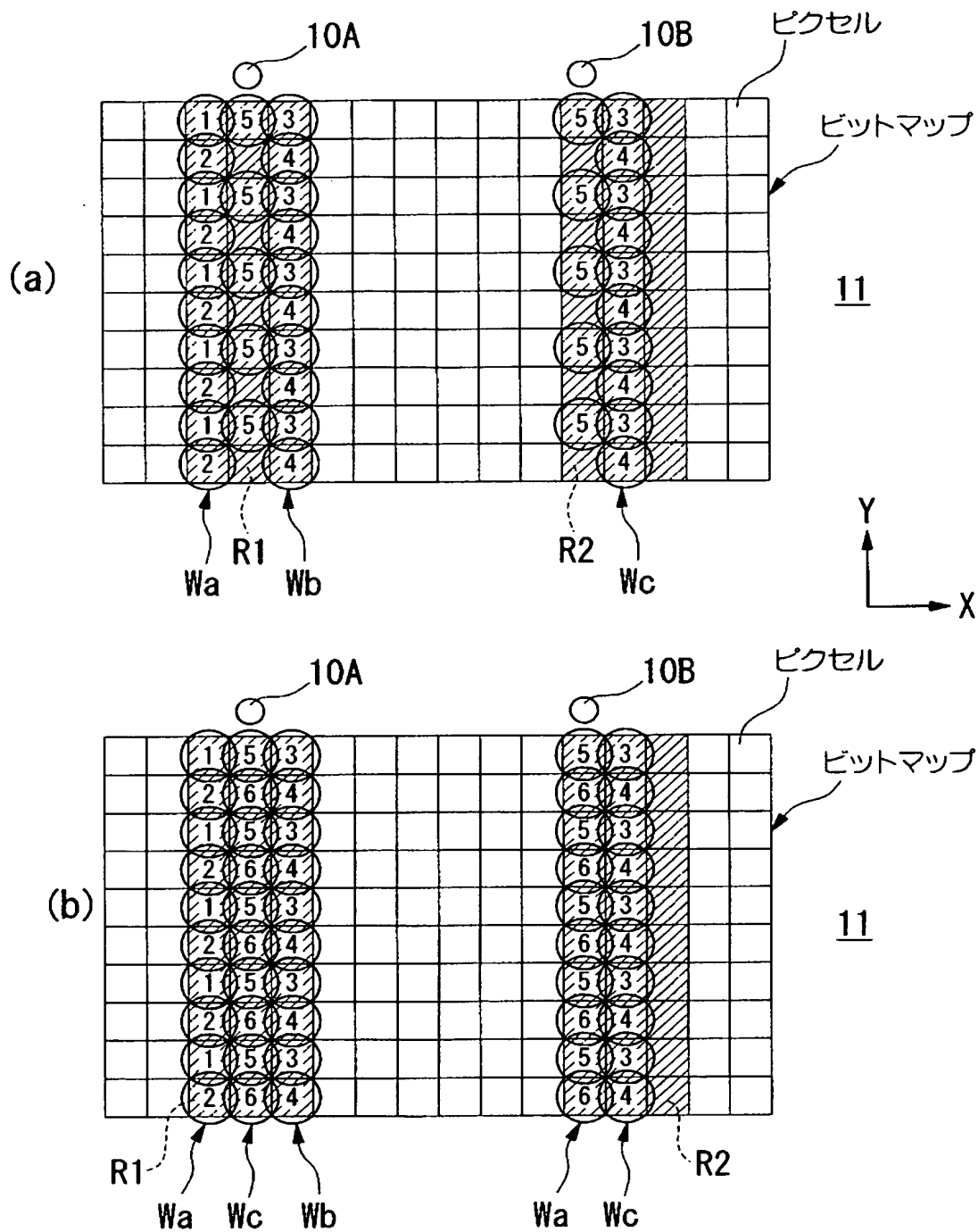
【図 4】



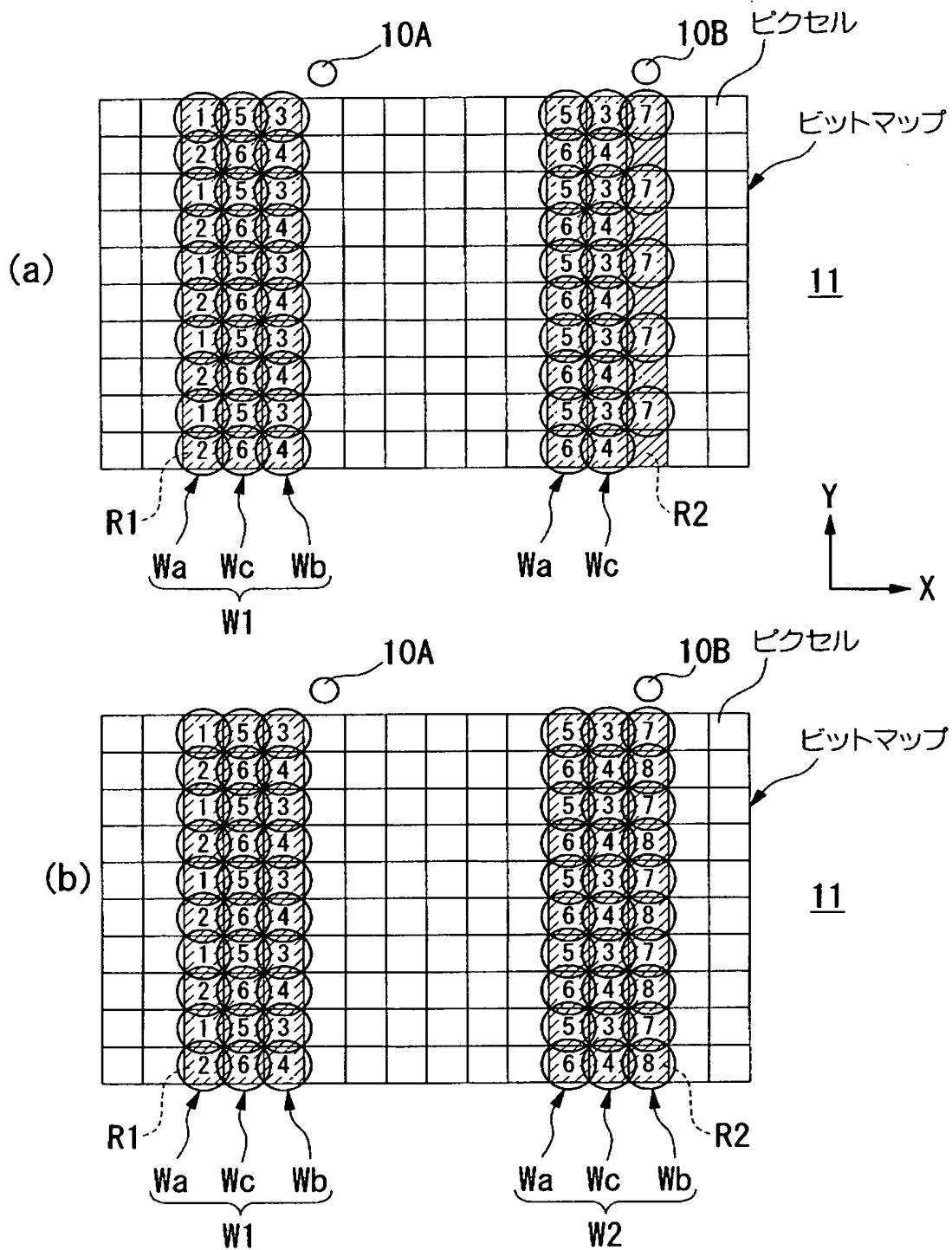
【図 5】



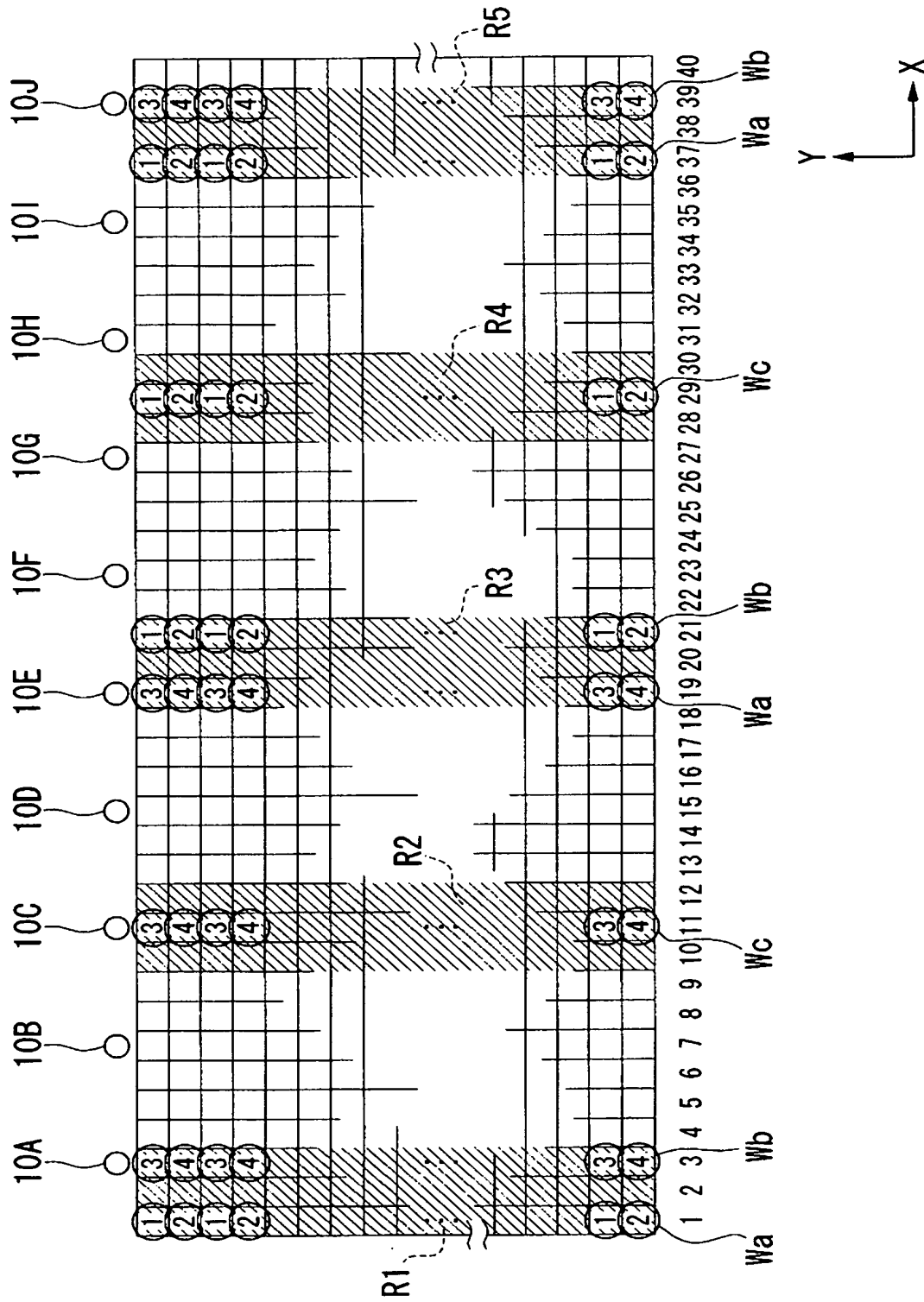
【図 6】



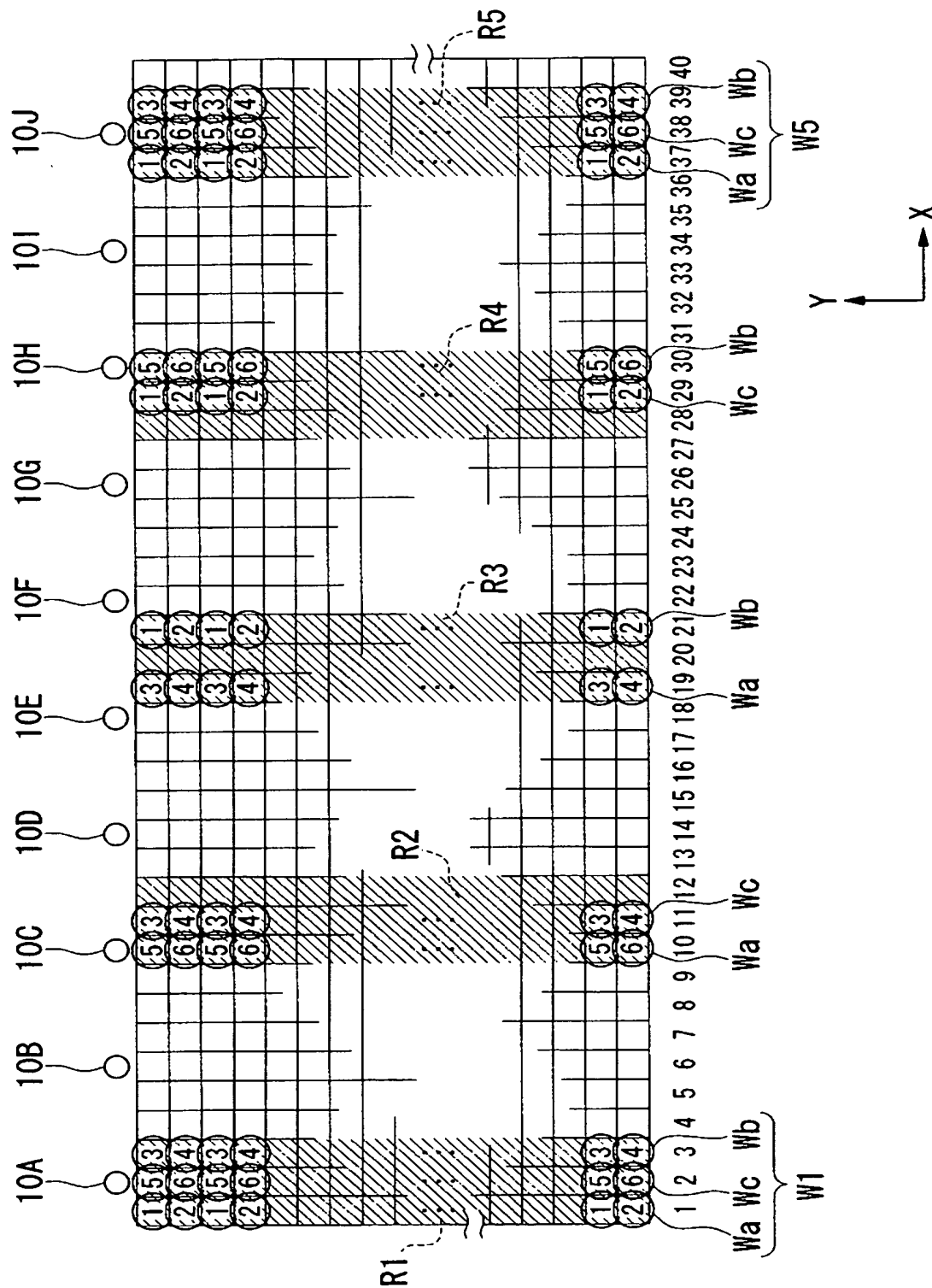
【図 7】



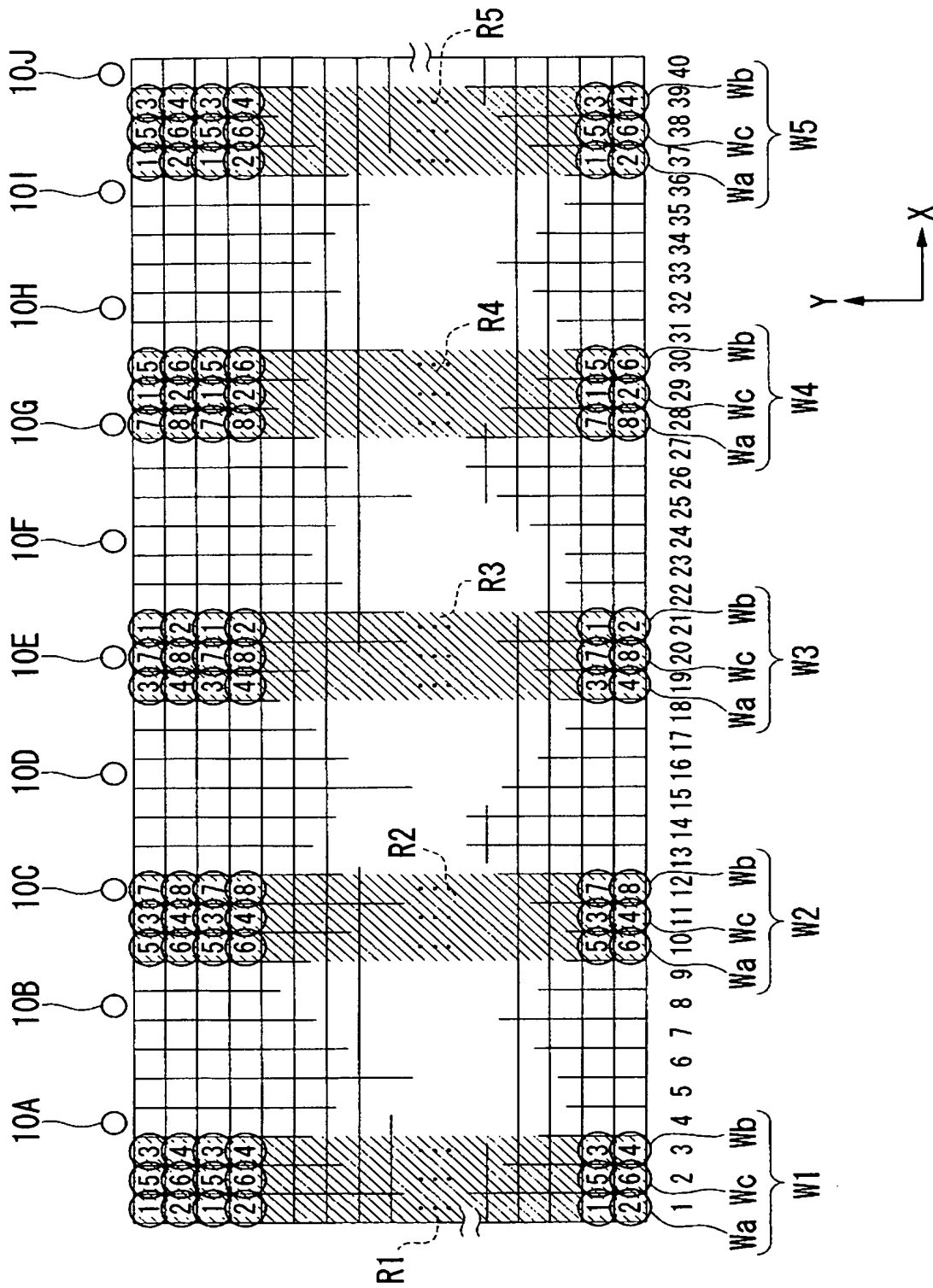
【図 9】



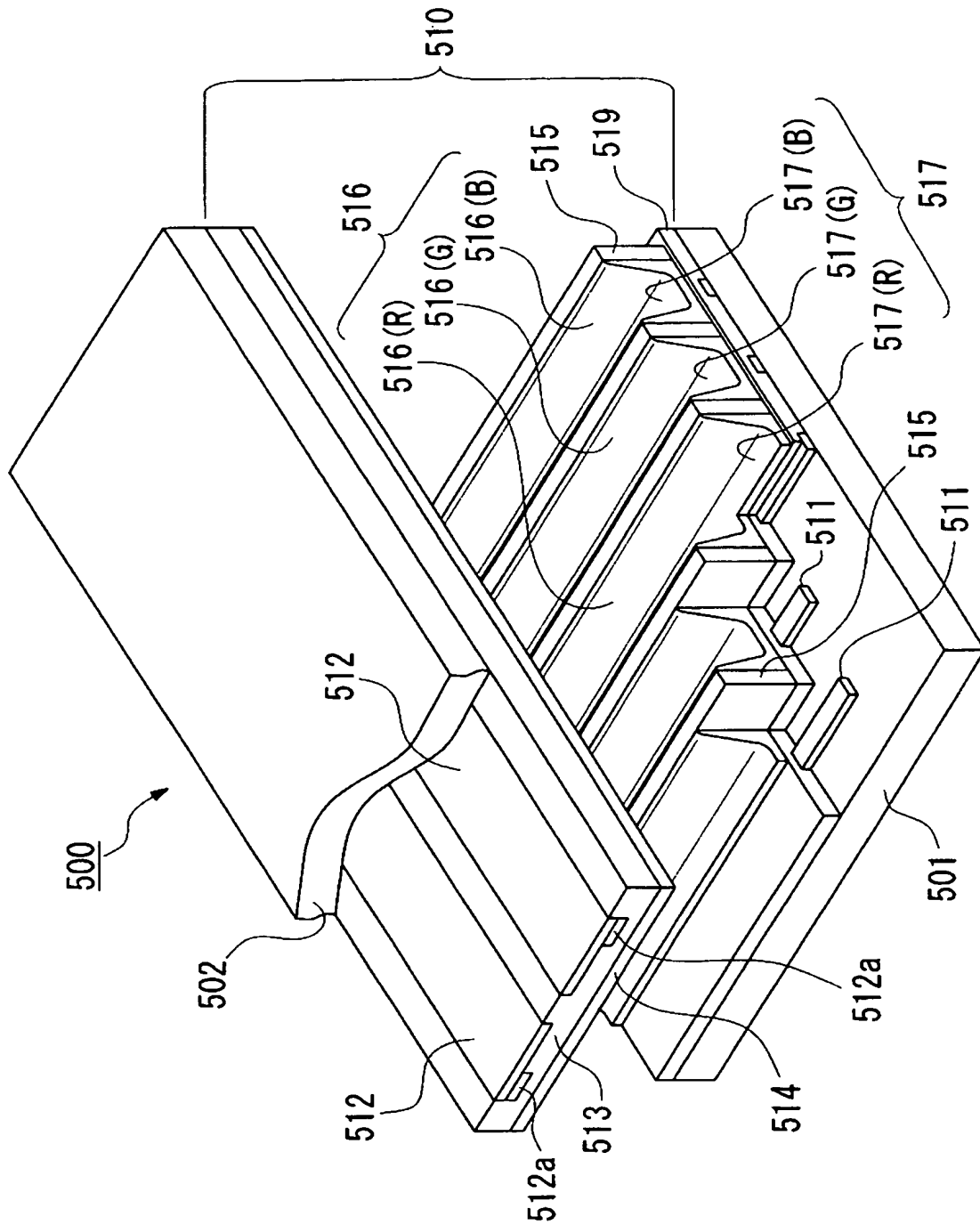
【図 10】



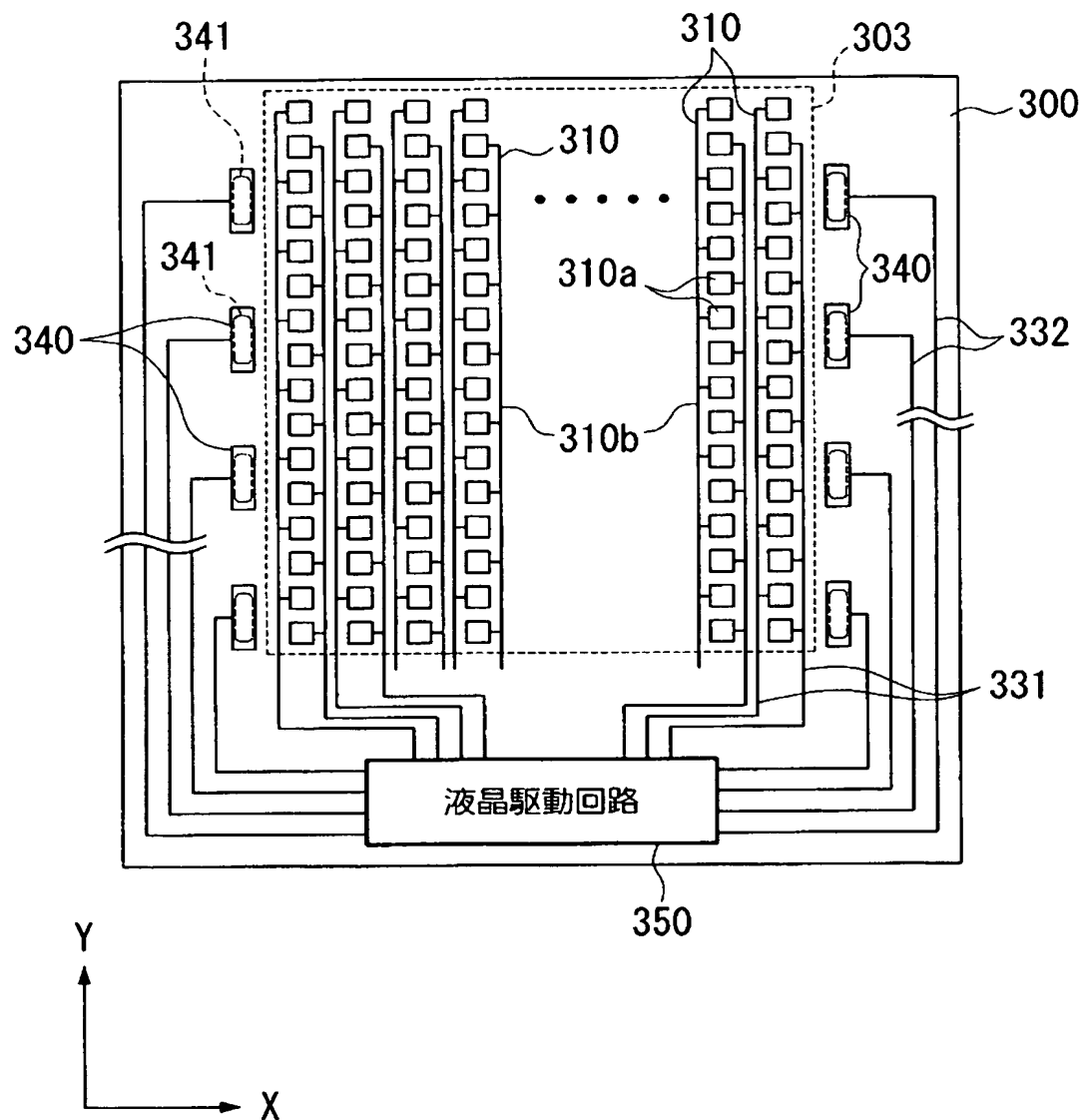
【図 11】



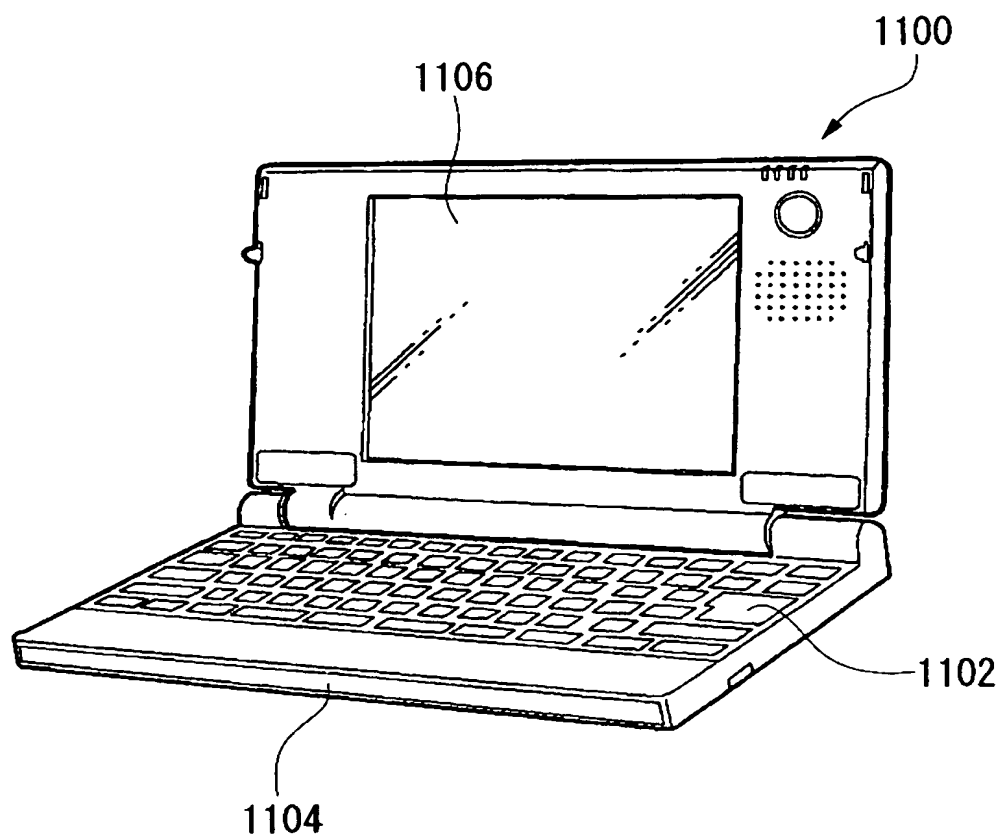
【図 13】



【図 14】



【図 15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数並んだ吐出ノズルのそれぞれから液滴を吐出して膜パターンを形成する際、膜パターンピッチが設計値上において種々変更されても効率良く膜パターンを形成できるパターンの形成方法を提供する。

【解決手段】 本発明のパターン形成方法は、液体材料の液滴を基板 1 1 上に配置することにより線状の膜パターン W 1、W 2 を形成する方法であって、基板 1 1 上に膜パターンを形成するパターン形成領域 R 1、R 2 を複数並べて設定し、複数のパターン形成領域 R 1、R 2 のうち、膜パターンの線幅方向側部から形成する第 1 パターン形成領域 R 1 と、膜パターンの線幅方向中央部から形成する第 2 パターン形成領域 R 2 とを設定し、第 1、第 2 パターン形成領域 R 1、R 2 のそれぞれに液滴を配置して膜パターン W 1、W 2 を形成する。

【選択図】 図 2



認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 6 5 3 2 4
受付番号	5 0 3 0 0 3 9 5 1 8 0
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0 0 9 3
作成日	平成 1 5 年 3 月 1 2 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年 3月11日

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 6 5 3 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 0 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
氏 名	セイコーエプソン株式会社